

(19) 日本国特許庁(JP)

再公表特許(A1)

(11) 国際公開番号

WO2008/149499

発行日 平成22年8月19日(2010.8.19)

(43) 国際公開日 平成20年12月11日(2008.12.11)

(51) Int. Cl.	F I	テーマコード (参考)
H05B 33/12 (2006.01)	H05B 33/12 B	3K107
H01L 51/50 (2006.01)	H05B 33/14 A	
H05B 33/22 (2006.01)	H05B 33/22 Z	
	H05B 33/22 C	

審査請求 有 予備審査請求 未請求 (全 54 頁)

出願番号	特願2008-553969 (P2008-553969)	(71) 出願人	000005821
(21) 国際出願番号	PCT/JP2008/001268		パナソニック株式会社
(22) 国際出願日	平成20年5月21日(2008.5.21)		大阪府門真市大字門真1006番地
(11) 特許番号	特許第4328384号 (P4328384)	(74) 代理人	100105050
(45) 特許公報発行日	平成21年9月9日(2009.9.9)		弁理士 鷲田 公一
(31) 優先権主張番号	特願2007-143906 (P2007-143906)	(72) 発明者	吉田 英博
(32) 優先日	平成19年5月30日(2007.5.30)		大阪府門真市大字門真1006番地 パナソニック株式会社内
(33) 優先権主張国	日本国 (JP)	(72) 発明者	北村 嘉朗
			大阪府門真市大字門真1006番地 パナソニック株式会社内
		(72) 発明者	山室 景成
			大阪府門真市大字門真1006番地 パナソニック株式会社内

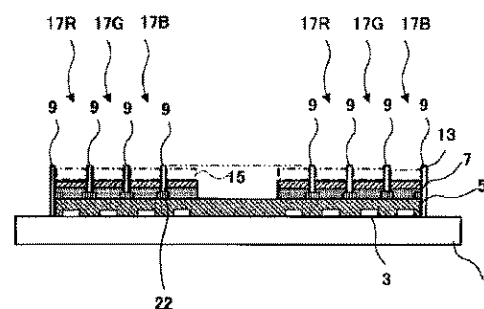
最終頁に続く

(54) 【発明の名称】 有機ELディスプレイパネルおよびその製造方法

(57) 【要約】

厚さの一定な高分子有機EL層を有する有機ELディスプレイパネルを提供する。本発明の有機ELディスプレイパネルは、基板上に配置されたアノード電極；前記アノード電極が配置された基板面に設けられた正孔輸送層；前記正孔輸送層上に設けられ、ライン状の画素領域を規定するライン状のバンク；前記画素領域内に配置されたライン状の中間層；前記画素領域内であって、前記中間層上に配置されたライン状の高分子有機EL層；および、前記高分子有機EL層上に設けられたカソード電極；を含む。

【図2A】



【特許請求の範囲】**【請求項 1】**

基板上に配置されたアノード電極；
前記アノード電極が配置された基板面に設けられた正孔輸送層；
前記正孔輸送層上に設けられ、ライン状の画素領域を規定するライン状のバンク；
前記画素領域内に配置されたライン状の中間層；
前記画素領域内であって、前記中間層上に配置されたライン状の高分子有機 E L 層；および
前記高分子有機 E L 層上に設けられたカソード電極；を含む有機 E L ディスプレイパネル。

10

【請求項 2】

前記バンクは、フッ素樹脂を含むか、または前記バンクの表面がフッ素系ガスプラズマによりフッ素化されている、請求項 1 に記載の有機 E L ディスプレイパネル。

【請求項 3】

前記正孔輸送層の材質は、タングステンオキシド (WO_x)、モリブデンオキシド (MoO_x)、バナジウムオキシド (VO_x)、またはこれらの組み合わせを含み、
前記ライン状のバンクから前記画素領域内にはみ出し、前記ライン状の中間層またはライン状の高分子有機 E L 層の底面に接する絶縁性の無機膜をさらに有する、
請求項 1 に記載の有機 E L ディスプレイパネル。

【請求項 4】

前記正孔輸送層上に配置された、前記画素領域の内部に 2 以上の副画素領域を規定する第 2 のバンクをさらに有し、前記第 2 のバンクは、隣接する副画素領域同士を連通する溝を有する、
請求項 1 に記載の有機 E L ディスプレイパネル。

20

【請求項 5】

前記アノード電極は基板上にマトリクス状に配置されているアクティブマトリクス型の請求項 1 に記載の有機 E L ディスプレイパネル。

【請求項 6】

前記高分子有機 E L 層は、前記画素領域に、高分子有機 E L 材料と溶媒とを含むインクをインクジェット、ディスペンサー、ノズルコート、凹版印刷または凸版印刷によりコートして形成される、請求項 1 に記載の有機 E L ディスプレイパネル。

30

【請求項 7】

前記中間層は、中間層の材料を含む溶液をスピンコート、ダイコート、またはスリットコートによりコートして形成される、請求項 1 に記載の有機 E L ディスプレイパネル。

【請求項 8】

基板上に配置されたアノード電極；
基板上に設けられ、ライン状の画素領域を規定するライン状のバンク；
前記画素領域内に配置されたライン状の正孔輸送層；
前記画素領域内に配置されたライン状の中間層；
前記画素領域内であって、前記中間層上に配置されたライン状の高分子有機 E L 層；および
前記高分子有機 E L 層上に設けられたカソード電極；を含む有機 E L ディスプレイパネル。

40

【請求項 9】

前記バンクは、フッ素樹脂を含むか、または前記バンクの表面がフッ素系ガスプラズマによりフッ素化されている、請求項 8 に記載の有機 E L ディスプレイパネル。

【請求項 10】

前記ライン状の正孔輸送層の材質は、タングステンオキシド (WO_x)、モリブデンオキシド (MoO_x)、バナジウムオキシド (VO_x)、またはこれらの組み合わせを含み、

50

前記ライン状のバンクから前記画素領域内にはみ出し、前記ライン状の中間層またはライン状の高分子有機ＥＬ層の底面に接する絶縁性の無機膜をさらに有する、
請求項８に記載の有機ＥＬディスプレイパネル。

【請求項１１】

前記ライン状の正孔輸送層の材質は、ポリエチレンジオキシチオフェンを含み、
前記ライン状のバンクから前記画素領域内にはみ出し、前記ライン状の正孔輸送層の底面に接する絶縁性の無機膜をさらに有する、
請求項８に記載の有機ＥＬディスプレイパネル。

【請求項１２】

前記正孔輸送層上に配置された、前記画素領域の内部に２以上の副画素領域を規定する第２のバンクをさらに有し、前記第２のバンクは、隣接する副画素領域同士を連通する溝を有する、
請求項８に記載の有機ＥＬディスプレイパネル。

10

【請求項１３】

前記アノードは基板上にマトリクス状に配置されているアクティブマトリクス型の請求項８に記載の有機ＥＬディスプレイパネル。

【請求項１４】

前記高分子有機ＥＬ層は、前記画素領域に、高分子有機ＥＬ材料と溶媒とを含むインクをインクジェット、ディスペンサー、ノズルコート、凹版印刷または凸版印刷によりコートして形成される、請求項８に記載の有機ＥＬディスプレイパネル。

20

【請求項１５】

前記中間層は、中間層の材料を含む溶液をスピンコート、ダイコート、またはスリットコートによりコートして形成される、請求項１０に記載の有機ＥＬディスプレイパネル。

【請求項１６】

前記正孔輸送層は、正孔輸送層の材料を含む溶液をスピンコート、ダイコート、またはスリットコートによりコートして形成される、請求項１１に記載の有機ＥＬディスプレイパネル。

【請求項１７】

基板面に第一の導電層を形成するステップ；
前記第一の導電層が形成された基板面に、正孔輸送層を形成するステップ；
前記正孔輸送層上に、ライン状の電気絶縁性の障壁を形成して、ライン状の画素領域となる領域を規定するステップ；
前記画素領域となる領域内に、ライン状の中間層を形成するステップ；
前記画素領域となる領域内に、高分子有機ＥＬ材料と溶媒を含むインクをインクジェット、ディスペンサー、ノズルコート、凹版印刷または凸版印刷によりライン状にコートして、ライン状の高分子有機ＥＬ層を形成するステップ；および
前記有機ＥＬ層に第二の導電層を形成するステップ；を含む有機ＥＬディスプレイパネルの製造方法。

30

【請求項１８】

基板面に第一の導電層を形成するステップ；
前記第一の導電層が形成された基板面に、ライン状の電気絶縁性の障壁を形成して、ライン状の画素領域となる領域を規定するステップ；
前記画素領域となる領域内に、ライン状の正孔輸送層を形成するステップ；
前記画素領域となる領域内に、ライン状の中間層を形成するステップ；
前記画素領域となる領域に、高分子有機ＥＬ材料と溶媒を含むインクをインクジェット、ディスペンサー、ノズルコート、凹版印刷または凸版印刷によりコートして、ライン状の高分子有機ＥＬ層を形成するステップ；および
前記有機ＥＬ層に第二の導電層を形成するステップ；を含む有機ＥＬディスプレイパネルの製造方法。

40

50

【発明の詳細な説明】

【技術分野】

【0001】

本発明は、有機ＥＬディスプレイパネルおよびその製造方法に関する。

【背景技術】

【0002】

有機ＥＬディスプレイパネルとは、有機化合物の電界発光を利用した発光素子を利用したディスプレイパネルである。つまり有機ＥＬディスプレイパネルは、陰極および陽極、ならびに両極の間に配置された電界発光する有機化合物を含むＥＬ素子を有する。電界発光する有機化合物は、低分子有機化合物の組み合わせ（ホスト材料とドーパント材料）と、高分子有機化合物とに大別されうる。電界発光する高分子有機化合物の例には、ＰＰＶと称されるポリフェニレンビニレンやその誘導体などが含まれる。電界発光する高分子有機化合物を利用した有機ＥＬディスプレイパネルは、比較的低電圧で駆動でき、消費電力が少なく、ディスプレイパネルの大画面化に対応しやすいと言われており、積極的に研究が行なわれている。

10

【0003】

電界発光する高分子有機化合物は、その発光する光の色（Ｒ，ＧまたはＢ）に応じて、各画素にインクジェットなどの印刷技術を用いて配置される。例えば、高分子有機化合物と溶媒を含むポリマーインクを、インクジェットヘッドから吐出して印刷する。各画素に電界発光する高分子有機化合物を含むインクを印刷するときに、隣り合う画素にポリマーインクが浸入しないようにする必要がある。

20

【0004】

隣り合う画素にポリマーインクが浸入しないようにするため、以下の２つの方法が採用されている。

第一は、画素に含まれる各副画素を規定する隔壁を設けて、各副画素だけに正確にポリマーインクを正確に滴下することによって、隣り合う画素へのインクの浸入を抑制する。

第二は、ライン状に配列された各画素を規定する障壁と、各画素の領域において副画素を規定する障壁とを設けて、各画素の領域全体（副画素と副画素の間の領域を含む）にポリマーインクを塗布する場合に、各画素を規定する障壁を、副画素を規定する障壁よりも高くして、隣接する画素へのポリマーインクの浸入を抑制する（例えば、特許文献１および特許文献２を参照）。

30

【0005】

第一の方法のように各副画素にポリマーインクを滴下するよりも、第二の方法のように複数の副画素を含む画素全体にポリマーインクを塗れば、全ての副画素に簡便かつ迅速にポリマーインクを提供することができる。しかしながら、第二の方法により画素に提供されたポリマーインクから作製される有機発光層の厚さは均一になりにくい。

【特許文献１】米国特許第６３８８３７７号明細書

【特許文献２】米国特許第７０９１６６０号明細書

【発明の開示】

【発明が解決しようとする課題】

40

【0006】

本発明者は、ライン状に配列した画素領域（複数の副画素を含む領域）に、電界発光する高分子有機化合物を含むポリマーインクを塗布して有機発光層を作製するステップを含む有機ＥＬディスプレイパネルの製造方法であって、より簡便な方法を検討した。それにより塗布されたポリマーインクから作製される有機発光層の厚さが不均一になる理由の一つが、その下地となる正孔輸送層または中間層の厚さが不均一であることを見出した。

【0007】

正孔輸送層や中間層の厚さが不均一となる理由は、画素領域を規定する障壁と、副画素領域を規定する障壁とを形成し；形成された障壁によって規定された領域内に正孔輸送層や中間層を形成するためである。つまり複雑な構造の障壁の内部に、正孔輸送層や中間層

50

を形成していたことが一因であることがわかった。

【課題を解決するための手段】

【０００８】

本発明者は、正孔輸送層や中間層を副画素ごとに独立して設けることなく、それらを複数の副画素で共有しても、有機ＥＬディスプレイが適切に動作することを見出した。

【０００９】

そこで、アノード電極が形成された基板面に、正孔輸送層または中間層を作製し；作製した正孔輸送層または中間層の上に、ライン状に配列した画素領域を規定する障壁と、必要に応じて各副画素を規定する障壁とを設け；さらに電界発光する高分子有機化合物を含むポリマーインクをライン状の画素領域全体に塗布して、均一な厚さを有する有機ＥＬ層を得ることを検討した。

10

さらに、アノード電極を形成した基板面にライン状に配列した画素領域を規定する障壁を設け；ライン状の画素領域上に正孔輸送層または中間層を作製し；正孔輸送層または中間層に各副画素を規定する障壁を設け；さらに電界発光する高分子有機化合物を含むポリマーインクをライン状の画素領域全体に塗布して、均一な厚さを有する有機ＥＬ層を得ることを検討した。

【００１０】

これらの手順によれば、複数の画素領域を含む基板全体、または複数の副画素領域を含む画素領域全体に、正孔輸送層または中間層を、いわゆる「べた塗り」することができるので、一定の厚さの正孔輸送層または中間層を得ることができる。「べた塗り」とは、スピンコート、ダイコート、スリットコートなどの手法による塗布を意味する。一定の厚さの正孔輸送層または中間層を作製することができるので、有機ＥＬ層の厚さも均一になりやすい。

20

【００１１】

すなわち本発明の第一は、以下に示す有機ＥＬディスプレイパネルに関する。

〔１〕 基板上に配置されたアノード電極；前記アノード電極が配置された基板面に設けられた正孔輸送層；前記正孔輸送層上に設けられ、ライン状の画素領域を規定するライン状のバンク；前記画素領域内に配置されたライン状の中間層；前記画素領域内であって、前記中間層上に配置されたライン状の高分子有機ＥＬ層；および、前記高分子有機ＥＬ層上に設けられたカソード電極；を含む有機ＥＬディスプレイパネル。

30

〔２〕 前記バンクは、フッ素樹脂を含むか、または前記バンクの表面がフッ素系ガスプラズマによりフッ素化されている、〔１〕に記載の有機ＥＬディスプレイパネル。

〔３〕 前記正孔輸送層の材質は、タングステンオキサイド（ WO_x ）、モリブデンオキサイド（ MoO_x ）、バナジウムオキサイド（ VO_x ）、またはこれらの組み合わせを含み、前記ライン状のバンクから前記画素領域内にはみ出し、前記ライン状の中間層またはライン状の高分子有機ＥＬ層の底面に接する絶縁性の無機膜をさらに有する、〔１〕または〔２〕に記載の有機ＥＬディスプレイパネル。

〔４〕 基板上に配置されたアノード電極；基板上に設けられ、ライン状の画素領域を規定するライン状のバンク；前記画素領域内に配置されたライン状の正孔輸送層；前記画素領域内に配置されたライン状の中間層；前記画素領域内であって、前記中間層上に配置されたライン状の高分子有機ＥＬ層；および、前記高分子有機ＥＬ層上に設けられたカソード電極；を含む有機ＥＬディスプレイパネル。

40

〔５〕 前記バンクは、フッ素樹脂を含むか、または前記バンクの表面がフッ素系ガスプラズマによりフッ素化されている、〔４〕に記載の有機ＥＬディスプレイパネル。

〔６〕 前記ライン状の正孔輸送層の材質は、タングステンオキサイド（ WO_x ）、モリブデンオキサイド（ MoO_x ）、バナジウムオキサイド（ VO_x ）、またはこれらの組み合わせを含み、前記ライン状のバンクから前記画素領域内にはみ出し、前記ライン状の中間層またはライン状の高分子有機ＥＬ層の底面に接する絶縁性の無機膜をさらに有する、〔４〕または〔５〕に記載の有機ＥＬディスプレイパネル。

〔７〕 前記ライン状の正孔輸送層の材質は、ポリエチレンジオキシチオフエンを含み

50

、前記ライン状のバンクから前記画素領域内にはみ出し、前記ライン状の正孔輸送層の底面に接する絶縁性の無機膜をさらに有する、[4]または[5]に記載の有機ＥＬディスプレイパネル。

【 0 0 1 2 】

さらに本発明の第二は、以下に示す有機ＥＬディスプレイパネルの製造方法に関する。

[8] 基板面に第一の導電層を形成するステップ；前記第一の導電層が形成された基板面に、正孔輸送層を形成するステップ；前記正孔輸送層上に、ライン状の電気絶縁性の障壁を形成して、ライン状の画素領域となる領域を規定するステップ；前記画素領域となる領域内に、ライン状の中間層を形成するステップ；前記画素領域となる領域内に、高分子有機ＥＬ材料と溶媒を含むインクをインクジェット、ディスペンサー、ノズルコート、凹版印刷または凸版印刷によりライン状にコートして、ライン状の有機ＥＬ層を形成するステップ；および、前記高分子有機ＥＬ層に第二の導電層を形成するステップ；を含む有機ＥＬディスプレイパネルの製造方法。

10

[9] 基板面に第一の導電層を形成するステップ；前記第一の導電層が形成された基板面に、ライン状の電気絶縁性の障壁を形成して、ライン状の画素領域となる領域を規定するステップ；前記画素領域となる領域内に、ライン状の正孔輸送層を形成するステップ；前記画素領域となる領域内に、ライン状の中間層を形成するステップ；前記画素領域となる領域内に、高分子有機ＥＬ材料と溶媒を含むインクをインクジェット、ディスペンサー、ノズルコート、凹版印刷または凸版印刷によりコートして、ライン状の有機ＥＬ層を形成するステップ；および、前記高分子有機ＥＬ層に第二の導電層を形成するステップ；を含む有機ＥＬディスプレイパネルの製造方法。

20

【発明の効果】

【 0 0 1 3 】

本発明の高分子有機ＥＬディスプレイパネルは、カソード電極とアノード電極に挟まれる各機能層（高分子有機ＥＬ層など）の厚さが均一となりうるので、従来のディスプレイパネルよりも発光特性が改善される。また、カソード電極とアノード電極に挟まれる各機能層のうち、高分子有機ＥＬ層を除く正孔輸送層や中間層を、いわゆる「ベタ塗り」することができるので、高分子有機ＥＬディスプレイパネルの製造プロセスが簡略化される。

【図面の簡単な説明】

【 0 0 1 4 】

30

【図 1 A】本発明の有機ＥＬディスプレイパネルの平面図である。

【図 1 B】カソード電極を除去した状態の有機ＥＬディスプレイパネルの平面図である。

【図 2 A】実施の形態 1 における、図 1 に示された有機ＥＬディスプレイパネルの A - A の断面図である。

【図 2 B】実施の形態 1 における、図 1 に示された有機ＥＬディスプレイパネルの B - B の断面図である。

【図 3】カソード電極を除去した状態の有機ＥＬディスプレイパネルの平面図である。

【図 4 A】実施の形態 2 における、図 3 に示された有機ＥＬディスプレイパネルの A - A の断面図である。

【図 4 B】実施の形態 2 における、図 3 に示された有機ＥＬディスプレイパネルの B - B の断面図である。

40

【図 5 A】実施の形態 3 における、図 3 に示された有機ＥＬディスプレイパネルの A - A の断面図である。

【図 5 B】実施の形態 3 における、図 3 に示された有機ＥＬディスプレイパネルの B - B の断面図である。

【図 6 A】実施の形態 4 における、図 1 に示された有機ＥＬディスプレイパネルの A - A の断面図である。

【図 6 B】実施の形態 4 における、図 1 に示された有機ＥＬディスプレイパネルの B - B の断面図である。

【図 7 A】実施の形態 5 における、図 3 に示された有機ＥＬディスプレイパネルの A - A

50

の断面図である。

【図 7 B】実施の形態 5 における、図 3 に示された有機 E L ディスプレイパネルの B - B の断面図である。

【図 8】逆テーパ形状の第 1 のバンクを有する有機 E L ディスプレイの断面図である。

【図 9】中間層の下に絶縁膜を有する有機 E L ディスプレイパネルの断面図である。

【図 10】中間層の下に絶縁膜を有する有機 E L ディスプレイパネルの断面図である。

【図 11】正孔輸送層の下に絶縁膜を有する有機 E L ディスプレイパネルの断面図である。

【発明を実施するための最良の形態】

【0015】

1. 本発明の有機 E L ディスプレイパネルについて

本発明の有機 E L ディスプレイパネルは、基板、アノード電極、カソード電極、ならびに両電極に挟まれた正孔輸送層、中間層および発光層を有する有機 E L 素子を有する。また、本発明の有機 E L ディスプレイパネルは第 1 のバンクを有する。

【0016】

本発明の有機 E L ディスプレイパネルは発光層として高分子有機 E L 材料を用いることが好ましい。さらに有機 E L 素子を駆動するための薄膜トランジスタ（駆動 T F T）を有し、有機 E L 素子のアノード電極と、駆動 T F T のソースまたはドレイン電極とが接続されている。

【0017】

本発明の有機 E L ディスプレイパネルは、有機 E L 素子の構造、特に各機能層の配置に特徴があるが、他の構成は、本発明の効果を損なわない限り公知の有機 E L ディスプレイパネルと同様にされうる。

例えば、本発明の有機 E L ディスプレイパネルは、アノード電極がライン状に配置されるパッシブマトリクス型か、またはアノード電極がマトリクス状に配置されるアクティブマトリクス型のいずれでもよく、かつボトムエミッション型（発光した光を、アノード電極や基板を通してとりだす）でも、トップエミッション型（発光した光を、カソード電極や封止膜などを通してとりだす）のいずれでもよい。

【0018】

本発明の有機 E L ディスプレイパネルの基板は、ボトムエミッション型か、トップエミッション型かによって、その材質が異なる。ボトムエミッション型の場合には、基板が透明であることが求められるので、ガラスや透明樹脂などの基板であればよい。一方、トップエミッション型の場合には、基板が透明である必要はなく、その材質は絶縁性であれば任意である。

【0019】

基板には、アノード電極が形成されている。有機 E L ディスプレイパネルがパッシブマトリクス型である場合、アノード電極はライン状に、複数本形成される。ライン状のアノード電極は、互いに並行であることが好ましい。有機 E L ディスプレイパネルがアクティブマトリクス型である場合、アノード電極は基板上にマトリクス状に複数個配置される。

【0020】

有機 E L ディスプレイパネルがボトムエミッション型の場合、アノード電極が透明電極であることが求められ、ITO などで形成すればよい。有機 E L ディスプレイパネルがトップエミッション型の場合には、アノード電極に光反射性が求められ、例えば銀を含む合金、より具体的には銀 - パラジウム - 銅合金（APC とも称する）などで形成すればよい。アノード電極層は、その表面にタングステン薄膜などを有していてもよい。

【0021】

アノード電極が形成された基板面には、正孔輸送層または中間層が形成されている。もちろん両方の層が形成されていてもよく、正孔輸送層、中間層の順に形成すればよい。また、正孔輸送層が形成されない場合もあり得る。

【0022】

正孔輸送層とは正孔輸送材料からなる層であり、正孔輸送材料の例には、ポリエチレンスルホン酸をドーブしたポリ(3,4-エチレンジオキシチオフェン)(PEDOT-PPSSと称される)や、その誘導体(共重合体など)が含まれる。正孔輸送層の厚さは通常、10nm以上100nm以下であり、約30nmでありうる。また、正孔輸送層の材質は、WO_x(タングステンオキサイド)やMoO_x(モリブデンオキサイド)、VO_x(バナジウムオキサイド)などの酸化物や、これらの組み合わせなどであってもよい。

【0023】

中間層は、正孔輸送層に電子が輸送されるのをブロックする役割や、高分子有機EL層に正孔を効率よく運ぶ役割などを有し、例えばポリアニリン系の材料からなる層である。中間層の厚さは通常、10nm以上100nm以下であり、約40nmでありうる。

10

【0024】

上述のように本発明では、正孔輸送層または中間層を、いわゆる「ベタ塗り」によって作製することができることを特徴とする。つまり、正孔輸送層や中間層をスピンコート法、ダイコート法、スリットコート法などによって容易に「面形成」または「ライン形成」でき、しかもその厚さを一定にすることができる。

【0025】

ここで「面形成」とは、機能層(正孔輸送層や中間層など)をアノード電極が配置された基板面に複数の画素領域に亘って面状に形成することを意味する。また「ライン形成」とは、後述するディスプレイパネル上に形成された複数のライン状の画素領域ごとに、機能層を形成することを意味する。

20

【0026】

本発明の有機ELディスプレイパネルは、発光層として高分子有機EL層を含むことが好ましい。有機EL層は、後述する第1のバンクで規定された画素領域内にライン形成されればよい。

【0027】

高分子有機EL材料は各画素から所望の発色(レッドR, グリーンG, ブルーB)が生じるように、適宜選択される。例えば、レッド画素の隣にグリーン画素を配置し、グリーン画素の隣にブルー画素を配置し、ブルー画素の隣にレッド画素を配置する。

【0028】

高分子有機EL材料と溶媒を含むインクを、インクジェットなどの塗布法によって画素領域に塗布することによって、容易に、かつ他の材料に損傷を与えることなく有機EL層を形成することができる。高分子有機EL材料の例には、ポリフェニレンビニレン(Poly phenylene vinylene (PPV))およびその誘導体、ポリアセチレン(Poly acetylene)およびその誘導体、ポリフェニレン(Poly phenylene (PPP))およびその誘導体、ポリパラフェニレンエチレン(Poly para phenylene ethylene (PPV))およびその誘導体、ポリ3-ヘキシルチオフェン(Poly 3-hexyl thiophene (P3HT))およびその誘導体、ポリフルオレン(Poly fluorene (PF))およびその誘導体などが含まれる。また高分子有機EL層の厚さは約50~100nm(例えば60nm)であることが好ましい。

30

【0029】

本発明の有機ELディスプレイは、画素領域を規定する第1のバンクを有する。

40

第1のバンクはライン状に複数本形成され、ライン状の画素領域を規定する。ライン状の第1のバンクは互いに並行であることが好ましい。また、アノード電極がライン状である場合、ライン状の第1のバンクのラインの方向と、アノード電極のラインの方向とは直交することが好ましい。

【0030】

第1のバンクの形状は順テーパー型であっても、逆テーパー型であってもよい。第1のバンクが逆テーパー型である場合は、後述するように、カソード同士の通電を防止することができる。一方で第1のバンクが順テーパー状である場合は、第1のバンクが逆テーパー状である場合と比較してカソード電極を薄くすることができる。

【0031】

50

第1のバンクの材質は絶縁性であれば任意であるが、絶縁性樹脂（ポリイミドなど）であることが好ましい。さらに、第1のバンクの表面は濡れ性が低い（例えば撥水性である）ことが好ましい。第1のバンクの水に対する接触角は、例えば60°以上である。そのため、第1のバンクの材質はフッ素樹脂を含む絶縁性樹脂であることが好ましい。または第1のバンクの表面を、フッ素系ガスプラズマでフッ素化することにより、濡れ性を低下させてもよい。

【0032】

第1のバンクは、露光・現像プロセスを含むフォトリソグラフィ法によって形成してもよいが、凹版印刷などによって形成してもよい。凹版印刷などで形成すれば、他の材質（正孔輸送層など）に損傷を与えにくい。

【0033】

第1のバンクは、画素領域を規定するとともに、カソードセパレータとしても機能しうる。カソードセパレータとは、カソード電極（後述）を分離するための部材であって、例えば蒸着により有機EL層上に形成されたカソード電極を、ライン状の画素領域ごとに分割する。

【0034】

本発明の有機ELディスプレイパネルは、高分子有機EL層上にカソード電極層を有する。カソード電極層の材質は、ボトムエミッション型か、トップエミッション型かによって、その材質が異なる。トップエミッション型の場合にはカソード電極が透明である必要があるので、ITO電極やIZO電極などを形成することが好ましい。高分子有機EL層とカソード電極層との間にはバッファ層等が形成されることが好ましい。一方、ボトムエミッション型の場合にはカソード電極が透明である必要はなく、任意の材質の電極を用いればよい。

【0035】

カソード電極は、各画素領域に配置された有機EL層上に形成されていればよいが、通常は画素領域全体を覆うように形成されている（図1A参照）。通常は、互いに隣接する画素領域に形成されたカソード電極同士が通電しないように、第1のバンクがカソードセパレータとなる。カソード電極は通常、蒸着法により形成されるので、第1のバンクの形状を逆テーパ形状にすれば（図8参照）、より確実に隣接するカソード電極同士の通電を防止できる。さらにカソード電極は、画素領域ごとに分離されていなくてもよい場合がある。つまり、アクティブマトリクス型のようにアノード電極が画素電極ごとに独立して制御されていれば、画素電極をドライブするTFE素子が独立しているので、カソード電極を複数の画素領域で共有することができる。

【0036】

本発明の有機ELディスプレイパネルに、さらにカソード電極を形成した面にカバー材を設けて封止してもよい。カバー材により水分や酸素の浸入を抑制する。

【0037】

本発明の有機ELディスプレイパネルは電気絶縁性の無機膜（以下「無機絶縁膜」という）をさらに有していてもよい。無機絶縁膜は電気絶縁性であることはもちろんであるが、濡れ性が高いことも好ましい。無機絶縁膜の材質の例にはシリコンオキサイド（ SiO_2 ）やシリコンナイトライド（ Si_3N_4 ）、シリコンオキシナイトライド（ SiON ）などが含まれる。無機絶縁膜の厚さは10nm～200nmであることが好ましい。

【0038】

無機絶縁膜はバンクから画素領域まではみ出していることが好ましい（図9、図10および図11参照）。好ましくは、無機絶縁膜はバンクから画素領域まで5～10μmはみ出している。

【0039】

バンクからはみ出した無機絶縁膜上に機能層（高分子有機EL層、正孔輸送層または中間層）の材料を含む溶液を塗布する。無機絶縁膜により溶液は画素領域全体に均一に塗布され、膜厚が均一な機能層を得ることができる。

10

20

30

40

50

【 0 0 4 0 】

また、図 9 のように無機絶縁膜 2 2 が副画素領域 1 7 まではみ出していることで、コンタクトホール 2 3 から注入された正孔が高分子有機 E L 層に浸入することが防止される。これにより、コンタクトホールのように発光が予定されない箇所が発光することが防止される。

【 0 0 4 1 】

前述の通り本発明有機 E L ディスプレイパネルは、第 1 のバンクと第 1 のバンクからはみ出した無機絶縁膜（任意）とを有するが、第 1 のバンクおよび無機絶縁膜の態様（形状および配置位置）は、正孔輸送層および中間層の態様に応じて、以下の 3 つの態様に分別されうる。以下、第 1 のバンクおよび絶縁性の無機膜の形状ならびに配置位置について、3 つの態様に分けて説明する。

10

【 0 0 4 2 】

（ 1 ）正孔輸送層が面形成される場合（図 2、図 4、図 5 および図 9 参照）

正孔輸送層

本態様では、正孔輸送層は、面形成される。本態様では正孔輸送層の材質はタングステンオキサイドなどの酸化物であることが好ましい。

【 0 0 4 3 】

中間層

本態様では、中間層は、正孔輸送層上の第 1 のバンクによって規定されたライン状の画素領域内に形成（ライン形成）されるか、正孔輸送層上に面形成される。好ましくは、中間層はライン形成される。

20

【 0 0 4 4 】

第 1 のバンク

本態様では第 1 のバンクは、面形成された正孔輸送層または中間層上に形成され、高分子有機 E L 層の領域または中間層および高分子有機 E L 層の領域を規定する（図 2、図 4、図 5、および図 9 参照）。つまり、1）中間層が面形成される場合、第 1 のバンクは中間層上に形成され、高分子有機 E L 層の領域を規定し（図 5 参照）、2）中間層がライン形成される場合、第 1 のバンクは正孔輸送層上に形成され、中間層および高分子有機 E L 層の領域を規定する（図 2、図 4 および図 9 参照）。

好ましくは、第 1 のバンクは正孔輸送層上に形成され、ライン形成された中間層および高分子有機 E L 層の領域を規定する（図 2、図 4 および図 9 参照）。

30

【 0 0 4 5 】

高分子有機 E L 層

高分子有機 E L 層は、第 1 のバンクによって規定されたライン状の画素領域内であって中間層上に形成（ライン形成）される。

【 0 0 4 6 】

無機絶縁膜

本態様では無機絶縁膜は、中間層または高分子有機 E L 層の底面に接するように正孔輸送層上または中間層上に形成される（図 9 参照）。つまり、1）中間層が面形成される場合、無機絶縁膜は、高分子有機 E L 層の底面に接するように中間層上に形成され、2）中間層がライン形成される場合、無機絶縁膜は、中間層の底面に接するように正孔輸送層上に形成される（図 9 参照）。

40

好ましくは、無機絶縁膜は、中間層の底面に接するように正孔輸送層上に形成される（図 9 参照）。無機絶縁膜が中間層の底面に接するように正孔輸送層上に配置されることで、第 1 のバンクで規定された画素領域内に中間層の材料を含む溶液を塗布して中間層をライン形成する場合、中間層の膜厚をより均一にすることができる（図 9 参照）。

【 0 0 4 7 】

本態様の有機 E L ディスプレイパネルは、1）正孔輸送層（面形成）、2）中間層（面形成）、3）第 1 のバンク、4）高分子有機 E L 層（ライン形成）の順で製造してもよいし、1）正孔輸送層（面形成）、2）第 1 のバンク、3）中間層（ライン形成）、4）高

50

分子有機 E L 層 (ライン形成) の順で製造してもよい。

好ましくは、本態様の有機 E L ディスプレイパネルは、1) 正孔輸送層 (面形成)、2) 第 1 のバンク、3) 中間層 (ライン形成)、4) 高分子有機 E L 層 (ライン形成) の順で製造される。

【0048】

(2) 正孔輸送層がライン形成され、正孔輸送層の材質がタングステンオキサイドなどの酸化物である場合 (図 10 参照)

正孔輸送層

本態様では、正孔輸送層の材質はタングステンオキサイドなどの酸化物である。正孔輸送層は、後述する第 1 のバンクによって規定される領域内に位置するようにライン形成される。正孔輸送層はアノード電極を覆うように形成されることが好ましい。

【0049】

中間層

本態様では、中間層は、第 1 のバンクによって規定されたライン状の画素領域内に形成 (ライン形成) されるか、正孔輸送層および基板上に面形成される。好ましくは、中間層はライン形成される。

【0050】

第 1 のバンク

本態様では第 1 のバンクは、基板上 (図 10 参照) または中間層上に形成され、高分子有機 E L 層の領域または中間層および高分子有機 E L 層の領域を規定する。つまり、1) 中間層が面形成される場合、第 1 のバンクは中間層上に形成され、高分子有機 E L 層の領域を規定し、2) 中間層がライン形成される場合、第 1 のバンクは基板上に形成され、中間層および高分子有機 E L 層の領域を規定する。

好ましくは、第 1 のバンクは基板上に形成され (図 10 参照)、ライン形成された中間層および高分子有機 E L 層の領域を規定する。

【0051】

高分子有機 E L 層

高分子有機 E L 層は、第 1 のバンクによって規定されたライン状の画素領域内であって中間層上に形成 (ライン形成) される。

【0052】

無機絶縁膜

本態様では無機絶縁膜は、中間層または高分子有機 E L 層の底面に接するように形成される (図 10 参照)。つまり、1) 中間層が面形成される場合、無機絶縁膜は、高分子有機 E L 層の底面に接するように中間層上に形成され、2) 中間層がライン形成される場合、無機絶縁膜は、中間層の底面に接するように形成される (図 10 参照)。

好ましくは、無機絶縁膜は、中間層の底面に接するように形成される (図 10 参照)。無機絶縁膜は、中間層の底面に接するように形成されるのであれば、正孔輸送層上に配置されてもよいし (図 10 A)、基板上に配置されてもよいし (図 10 B)、基板上であって正孔輸送層の下に配置されてもよい (図 10 C)。無機絶縁膜が中間層の底面に接するように形成されることで、第 1 のバンクで規定された画素領域内に中間層の材料を含む溶液を塗布して中間層をライン形成する場合、中間層の膜厚をより均一にすることができる (図 10 参照)。また、第 1 のバンクと正孔輸送層との間に無機絶縁膜が配置されることで (図 10 A)、第 1 のバンクと酸化物からなる正孔輸送層との接着性が高まる。

【0053】

本態様の有機 E L ディスプレイパネルは、1) 正孔輸送層 (ライン形成)、2) 中間層 (面形成)、3) 第 1 のバンク、4) 高分子有機 E L 層 (ライン形成) の順で製造してもよいし、1) 正孔輸送層 (ライン形成)、2) 第 1 のバンク、3) 中間層 (ライン形成)、4) 高分子有機 E L 層 (ライン形成) の順で製造してもよい。

好ましくは、本態様の有機 E L ディスプレイパネルは、1) 正孔輸送層 (ライン形成)、2) 第 1 のバンク、3) 中間層 (ライン形成)、4) 高分子有機 E L 層 (ライン形成)

の順で製造される。

【 0 0 5 4 】

(3) 正孔輸送層がライン形成され、正孔輸送層の材質が P E D O T - P S S である場合 (図 1 1 参照)

正孔輸送層

本態様では、正孔輸送層は後述する第 1 のバンクによって規定されるライン状の画素領域内に P E D O T - P S S を塗布することでライン形成される。

【 0 0 5 5 】

中間層

本態様では、中間層は、第 1 のバンクによって規定されたライン状の画素領域内であって正孔輸送層上に形成 (ライン形成) される。

【 0 0 5 6 】

高分子有機 E L 層

高分子有機 E L 層は、第 1 のバンクによって規定されたライン状の画素領域内であって中間層上に形成 (ライン形成) される。

【 0 0 5 7 】

第 1 のバンク

本態様では、第 1 のバンクは基板面に形成され、正孔輸送層、中間層および高分子有機 E L 層の領域を規定する (図 1 1 参照) 。

【 0 0 5 8 】

無機絶縁膜

本態様における無機絶縁膜は正孔輸送層の底面に接するように基板上に配置される (図 1 1 参照) 。無機絶縁膜が正孔輸送層の底面に接するように形成されることで、P E D O T - P S S を材料とする正孔輸送層の膜厚をより均一にすることができる。

【 0 0 5 9 】

本態様の有機 E L ディスプレイパネルは、1) 第 1 のバンク、2) 正孔輸送層 (ライン形成) 、3) 中間層 (ライン形成) 、4) 高分子有機 E L 層 (ライン形成) の順で製造されることが好ましい。

【 0 0 6 0 】

このように本発明の有機 E L ディスプレイパネルは正孔輸送層および中間層の態様 (形状および材質) によって、第 1 のバンク、および無機絶縁膜層の配置位置が異なる。一方で高分子有機 E L 層、カソード電極および後述する第 2 のバンクの配置位置は、上記 3 つの態様において共通する。

【 0 0 6 1 】

本発明の有機 E L ディスプレイパネルは、さらに第 2 のバンクを有していてもよい。

第 2 のバンクは画素領域内に 2 以上の副画素領域を規定する。第 2 のバンクは正孔輸送層上に配置されていてもよく、または中間層上に配置されていてもよい。第 2 のバンクが正孔輸送層上に配置された場合、中間層および高分子有機 E L 層が第 2 のバンクによって規定される。一方、第 2 のバンクが中間層上に配置された場合、高分子有機 E L 層が第 2 のバンクによって規定される。

第 2 のバンクは、好ましくは正孔輸送層上に配置され、中間層および高分子有機 E L 層を規定する。

【 0 0 6 2 】

第 2 のバンクの材料は、第 1 のバンクと同様に絶縁性であれば特に限定されないが、絶縁性樹脂であることが好ましい。第 2 のバンクにより画素間の電氣的なクロストークを抑制することができる。さらに第 2 のバンクの材料は、黒色であることが好ましい。第 2 のバンクは副画素領域を規定するので、副画素領域から発せられる光とのコントラストの高い色のバンクとすることにより、輝度の高いディスプレイパネルが得られる。

【 0 0 6 3 】

また副画素領域を規定する第 2 のバンクは正孔輸送層または中間層上に配置されるので

10

20

30

40

50

、第2のバンクと正孔輸送層または中間層とを互いに密着させることが好ましい。したがって、第2のバンクの表面の濡れ性を、第1のバンクの表面の濡れ性よりも高くして、正孔輸送層または中間層との密着性を高めてもよい。例えば、第2のバンクの水に対する接触角は40°以下である。そのため、第2のバンクの材質は、非フッ素系樹脂（非フッ素系ポリイミド樹脂や非フッ素系ポリアクリル樹脂など）でありうる。

【0064】

このように第2のバンクは、正孔輸送層または中間層の上に形成される。したがって正孔輸送層または正孔輸送層および中間層を、いわゆる「ベタ塗り」によって作製することができる。つまり、正孔輸送層や中間層をスピンコート法、ダイコート法、スリットコート法などによって容易に形成でき、しかもその厚さを一定にすることができる。

10

【0065】

第2のバンクの深さは、1～2μm程度であればよい。また、第2のバンクの頂点の基板からの高さよりも、第1のバンクの頂点は、約1～10μm高いことが好ましい。後述するように、第1のバンクで規定される画素領域に、高分子有機EL材料と溶液を含むインクを塗布することにより有機EL層を形成するので、画素領域を規定する障壁を高くして隣接する画素領域にインクが浸入することを防止するためである。

【0066】

副画素領域を規定する第2のバンクには、隣接する副画素領域同士を連通する溝が設けられていてもよい（図3参照）。第2のバンクを形成後、第2のバンクによって規定された副画素領域には、中間層の材料を含む溶液または高分子有機EL材料を含むインクが画素領域に塗布されうる。したがって、副画素領域同士を連通する溝が設けられていると、副画素領域の間を溶液またはインクが移動でき、形成される中間層または有機EL層の厚さが画素領域内において平準化される。溝の深さは第2のバンクの深さの9割以内であればよく、溝の幅は約20～50μmであればよい。また、隣接する副画素領域同士の間隔は、通常は10μm以上である。副画素領域の横幅（第1のバンクのラインの方向を縦とする）は、約60～100μmである。

20

【0067】

2. 本発明の有機ELディスプレイパネルの製造方法について

本発明の有機ELディスプレイパネルは、本発明の効果を損なわない限り、任意の方法で製造されうる。

30

好ましい製造方法の第1の例は、1) 基板に第一の導電層を面形成するステップ、2) 前記第一の導電層が形成された基板面に、正孔輸送層を形成するステップ、3) 前記正孔輸送層上に、ライン状の電気絶縁性の障壁を形成して、ライン状の画素領域となる領域を規定するステップ、4) 前記画素領域となる領域内に、ライン状の有機EL層を形成するステップ、および5) 前記有機EL層に第二の導電層を形成するステップを含む。

【0068】

1) ステップにおいて、第一の導電層は、基板に導電体薄膜を成膜して、フォトリソグラフィ加工またはエッチング加工によりライン状（図3参照）またはマトリクス状（図1B参照）にパターニングするなどして形成すればよいが、特にその手法は限定されない。第1の導電層はアノード電極となる。

40

【0069】

2) ステップにおいて、正孔輸送層の材質がPEDOT-PPSである場合、第1の導電層が形成された基板面に正孔輸送層を面形成するには、スピンコート、ダイコート、またはスリットコート法などを採用することが好ましい。簡便な方法でありながら、比較的均一な厚さの層を形成することができる。一方、正孔輸送層の材質がタングステンオキサイドなどの酸化物である場合、正孔輸送層は例えばスパッタ法や加熱蒸着法によって形成される。

【0070】

3) ステップでは正孔輸送層上に画素領域を規定するライン状の電気絶縁性の障壁を形成する。第1の導電層がライン状に形成されている場合（図3参照）、ライン状の障壁の

50

ライン方向は、ライン状の導電層のライン方向に直交することが好ましい。当該障壁は、正孔輸送層にレジストを塗布し、フォトリソでライン状に感光させて形成してもよく、凹版印刷により絶縁性樹脂成型物を印刷してもよい。前者の方法では、照射する光によって正孔輸送層や中間層に損傷を与えることがあるので、好ましくは後者の方法を採用する。当該ライン状の障壁により、画素領域となる領域が規定される。また、当該障壁はカソード電極セパレータとなりうる。

【0071】

画素領域に、さらに第2の電気絶縁性の障壁を形成してもよい。当該障壁も、正孔輸送層上にレジストを塗布し、フォトリソでライン状に感光させて形成してもよく、凹版印刷により絶縁性樹脂を印刷してもよい。当該障壁により、副画素となる複数の領域が規定される。また当該障壁は、副画素となる領域を規定するが、隣接する領域同士を連通する溝を有していてもよい。溝はエッチングなどで形成してもよい。また、凹版印刷により予め溝が形成された樹脂成型物を印刷してもよい。

10

【0072】

ライン状の電気絶縁性の障壁の形成と、副画素となる領域を規定する領域の形成とは、いずれを先に行なってもよく、同時に行なってもよい。例えば、凹版印刷により絶縁性樹脂を印刷する場合には、所望の形状の樹脂成型物を印刷することによって、両方の障壁を同時に形成することができる。

【0073】

本製造方法の例は、3)ステップの前または後に中間層を形成するステップを有していてもよい。つまり、3)ステップの前に中間層を形成する場合、中間層は正孔輸送層上に面形成することが好ましい。一方、3)ステップの後に中間層を形成する場合、中間層をライン状の電気絶縁性の障壁の形成後に障壁によって規定された画素領域内に形成(ライン形成)することが好ましい。

20

中間層を形成するにはスピコート、ダイコート、またはスリットコート法などを採用することが好ましい。

【0074】

また本製造方法の例は、3)ステップの前であって中間層の形成前、または3)ステップの前であって中間層の形成後に、無機絶縁膜を形成するステップを有していてもよい。

つまり、中間層が面形成される場合、無機絶縁膜は、中間層上であって、電気絶縁性の障壁の下に形成される。一方、中間層がライン形成される場合、無機絶縁膜は、正孔輸送層上であって、電気絶縁性の障壁の下に形成される。

30

無機絶縁膜は例えば、プラズマCVD法やスパッタ法によって形成される。

【0075】

正孔輸送層は、基板面全体に形成してもよいが、少なくとも全ての画素領域を含む領域に形成すればよい。

通常は、正孔輸送層および中間層のいずれもが形成されるが、正孔輸送層は形成されないこともありうる。

【0076】

4)ステップにおいて規定された画素領域内に、高分子有機EL材料と溶媒を含むインクをコートする。コートは、インクジェット、ディスペンサー、ノズルコート、凹版印刷または凸版印刷などの手法を用いて行なえばよい。ディスペンサーにより塗布する場合は、塗布するラインの始端と終端でサックバック動作などにより、ディスペンサーからのインクの吐出を制御することが好ましい。塗布されたインクの厚み(コート膜の厚み)は、約1~10 μm とすればよい。さらにコート膜を乾燥させることによって高分子有機EL材料を含む層が形成され、好ましくは画素領域内の副画素領域に選択的に形成される。

40

【0077】

さらに高分子有機EL材料を含む層をスキージしてもよい。具体的にスキージは、コーターなどを用いて行なえばよい。スキージにより、高分子を構成する構造単位の配向性を高めることができ、発光効率を向上させることができる。

50

【 0 0 7 8 】

5) ステップにおいて、有機 E L 層上に第二の導電層を形成する。第 2 の導電層は蒸着法により作製されればよい。ライン状の電気絶縁性の障壁を逆テーパ形状にすれば、より確実に第二の導電層を画素毎に切断することができる。

【 0 0 7 9 】

好ましい製造方法の第 2 の例は、1) 基板面に第一の導電層を形成するステップ、2) 前記第一の導電層が形成された基板面に、ライン状の電気絶縁性の障壁を形成して、ライン状の画素領域となる領域を規定するステップ、3) 前記画素領域となる領域内に、ライン状の正孔輸送層を形成するステップ、4) 前記画素領域となる領域内に、ライン状の中間層を形成するステップ、5) 前記画素領域となる領域に、ライン状の高分子有機 E L 層を形成するステップ、および 6) 前記有機 E L 層に第二の導電層を形成するステップを含む。

10

【 0 0 8 0 】

また上記製造方法は、1) ステップと 2) ステップとの間に、基板上に絶縁性の無機膜(以下、「無機絶縁膜」という)を形成するステップを有していてもよい。この場合、画素領域を規定する電気絶縁性の障壁は、無機絶縁膜上に形成されることが好ましい。

【 0 0 8 1 】

また、正孔輸送層の材質がタングステンオキサイドなどの酸化物である場合、2) ステップと 3) ステップとは順序が逆であってもよい。

【 0 0 8 2 】

製造方法の第 2 の例における、基板面に第一の導電層を形成するステップ、ライン状の高分子有機 E L 層を形成するステップ、および第二の導電層を形成するステップは、第 1 の例と同様のステップであり、同様の手段で行なえばよい。

20

【 0 0 8 3 】

2) ステップにおいて、第 1 の導電層が形成された基板面に、ライン状の電気絶縁性の障壁を形成する。第 1 の導電層がライン状に形成されている場合、ライン状の障壁のライン方向は、ライン状の導電層のライン方向と直交することが好ましい。当該障壁は、基板面にレジストを塗布し、フォトリソでライン状に感光させて形成してもよく、凹版印刷により絶縁性樹脂成型物を印刷してもよい。当該障壁により画素領域が規定される。また当該障壁は、カソードセパレータとなりうる。

30

【 0 0 8 4 】

3) ステップにおいてライン状の電気絶縁性の障壁により規定された画素領域に、正孔輸送層を形成し、4) ステップにおいてライン状の電気絶縁性の障壁により規定された画素領域内であって正孔輸送層上に中間層を形成する。正孔輸送層または中間層は、スピコート、ダイコートまたはスリットコートなどの手段で形成することができる。

【 0 0 8 5 】

画素領域内に配置された正孔輸送層上に、第 2 の電気絶縁性の障壁を形成して、副画素領域を規定してもよい。副画素領域を規定する障壁は、正孔輸送層にレジストを塗布し、フォトリソでライン状に感光させて形成してもよく、凹版印刷により絶縁性樹脂成型物を印刷してもよい。

40

副画素領域を規定した後、第 1 の例の製造方法と同様にして、画素領域に高分子有機 E L 材料と溶媒を含むインクをコートして、有機 E L 層を形成する。

【 0 0 8 6 】

以下において、図面を参照して本発明の実施形態をより詳細に説明する。

【 0 0 8 7 】

[実施の形態 1]

実施の形態 1 では正孔輸送層が面形成されるアクティブマトリクス型有機 E L ディスプレイパネルについて説明する。

【 0 0 8 8 】

図 1 A はアクティブマトリクス型の有機 E L ディスプレイパネルの平面図である。図 1

50

Aに示されたパネルには、ライン状に形成された副数本の第1のバンク9が配置されている。第1のバンク9は画素領域17を規定している。画素領域17は、レッドの光を発光する画素領域17R；グリーン光を発光する画素領域17G；ブルーの光を発光する画素領域17Bに分類され、順番に配置されている。画素領域17は、カソード電極15で覆われており、第1のバンク9によって画素領域毎に分離されている。

【0089】

図1Bはカソード電極を除去した本実施の形態のアクティブマトリクス型の有機ELディスプレイパネルの平面図である。

【0090】

図2Aには、図1Bに示された本実施の形態の有機ELディスプレイパネルの線A-Aの断面図が示される。図2Bには、図1Bに示された本実施の形態の有機ELディスプレイパネルの線B-Bの断面図が示される。

【0091】

図2Aおよび図2Bに示されるように、本実施の形態では、基板1上にマトリクス状のアノード電極3が配置される。正孔輸送層5はアノード電極3を覆うように基板1上に面形成される。第1のバンク9は正孔輸送層5上に無機絶縁膜22を介して配置され画素領域17を規定する。第1のバンク9は、濡れ性を下げるためフッ素樹脂などで形成されることが好ましい。中間層7は画素領域17内の正孔輸送層5上に配置される。中間層7上の画素領域17には高分子有機EL層13が配置される。

【0092】

[実施の形態2]

実施の形態1ではアクティブマトリクス型有機ELディスプレイパネルについて説明した。実施の形態2ではパッシブマトリクス型有機ELディスプレイパネルについて説明する。また本実施の形態では有機ELディスプレイパネルは第2のバンクを有する。

【0093】

図3は、本実施の形態の有機ELディスプレイからカソード電極15を除去した状態の平面図である。図3に示されたパネルは、基板1と、ライン状に形成された複数本のアノード電極3'と、ライン状に形成された副数本の第1のバンク9が配置されている。アノード電極3'のラインの方向(図面横方向)と、第1のバンク9のラインの方向(図面縦方向)とは、直角に交差している。

【0094】

画素領域17の内部には、第2のバンク11で規定された2以上の副画素領域19が配置されている。同一の画素領域17において互いに隣接する副画素領域19は、溝21によって連通している。副画素領域19および溝21には、各色に対応する高分子有機EL材料13が配置されている。

【0095】

図4Aには、図3に示された本実施の形態の有機ELディスプレイパネルの線A-Aの断面図が示される。図4Bには、図3に示された本実施の形態の有機ELディスプレイパネルの線B-Bの断面図が示される。

【0096】

図4Aおよび図4Bに示されるように、本実施の形態の有機ELディスプレイパネルは、アノード電極3'および第2のバンク11を有することならびに無機絶縁膜22を有しないこと以外は実施の形態1の有機ELディスプレイパネルと同じである。したがって、実施の形態1の有機ELディスプレイパネルと同一の部材については同一の符号を付して説明を省略する。

【0097】

図4Aおよび図4Bに示されるように、基板1上にライン状のアノード電極3'が配置される。正孔輸送層5は、アノード電極3'を覆うように基板1上に面形成される。

中間層7上には第2のバンク11が配置され副画素領域19を規定する。第1のバンク9の頂点は、第2のバンク11の頂点よりも、基板1から高い。その高さの差は、例えば

10

20

30

40

50

1 μm 以上10 μm 以下である。また、第2のバンク11は、中間層7との密着性を考慮して、ある程度の濡れ性を有することが好ましい。

【0098】

高分子有機EL材料13は、副画素領域19内にパターンニングされているか、または画素領域17にパターンニングされている。

【0099】

図4Bに示されるように、第2のバンク11の(図中左右の)両端よりも、内部の第2のバンク11は低くされている。内部の第2のバンク11は溝21(図3参照)に対応している。内部の第2のバンク11(溝21)を覆うようにして、高分子有機EL層13が配置されている。つまり、溝21は、隣接する副画素領域19同士を連通させている。第1のバンク9で規定された画素領域17に、高分子有機EL材料を含むポリマーインクを塗布した場合に、副画素領域19が互いに連通することなく独立していると、各副画素領域19に形成される高分子有機EL層13の厚さが一定となりにくい。一方、溝21を設けておくと、画素領域17に塗布されたポリマーインクが、副画素領域19同士を移動できるので、高分子有機EL層13の厚さが平準化される。

【0100】

[実施の形態3]

実施の形態1および2では正孔輸送層が面形成され、中間層がライン形成された有機ELディスプレイパネルについて説明した。実施の形態3では、中間層が面形成される有機ELディスプレイパネルについて説明する。また本実施の形態の有機ELディスプレイパネルは、パッシブマトリクス型であり、第2のバンクを有する。

【0101】

本実施の形態の有機ELディスプレイパネルの平面図は実施の形態2と同じである。したがって図3は本実施の有機ELディスプレイパネルの平面図でもある。

【0102】

図5Aには、図3に示された本実施の形態の有機ELディスプレイパネルの線A-Aの断面図が示される。図5Bには、図3に示された本実施の形態の有機ELディスプレイパネルの線B-Bの断面図が示される。

【0103】

図5Aおよび図5Bに示されるように、本実施の形態の有機ELディスプレイパネルは、中間層5の形状および第1のバンク9の配置位置以外は実施の形態2の有機ELディスプレイパネルと同じである。したがって、実施の形態2の有機ELディスプレイパネルと同一の部材については同一の符号を付して説明を省略する。

【0104】

図5Aおよび図5Bに示されるように、中間層7は面形成された正孔輸送層5の上に面形成される。面形成された中間層7上には第1のバンク9、第2のバンク11および高分子有機EL層13が配置される。

【0105】

[実施の形態4]

実施の形態1~3では、正孔輸送層が面形成される有機ELディスプレイパネルについて説明した。実施の形態4では、正孔輸送層がライン形成される有機ELディスプレイパネルについて説明する。また、本実施の形態の有機ELディスプレイパネルはアクティブマトリクス型である。

【0106】

本実施の形態の有機ELディスプレイパネルの平面図は実施の形態1と同じである。したがって図1Aおよび図1Bは本実施の有機ELディスプレイパネルの平面図でもある。

【0107】

図6Aには、図1Bに示された本実施の形態の有機ELディスプレイパネルの線A-Aの断面図が示される。図6Bには、図1Bに示された本実施の形態の有機ELディスプレイパネルの線B-Bの断面図が示される。

【 0 1 0 8 】

図 6 A および図 6 B に示されるように本実施の形態の有機 E L ディスプレイパネルは、正孔輸送層 5 の形状、第 1 のバンク 9 および無機絶縁膜 2 2 の配置位置以外は、実施の形態 1 の有機 E L ディスプレイパネルと同じである。したがって、実施の形態 1 の有機 E L ディスプレイパネルと同一の構成要素については同一の符号を付して説明を省略する。

【 0 1 0 9 】

図 6 A で示されるように、正孔輸送層 5 は第 1 のバンク 9 によって規定された画素領域 1 7 内にライン形成される。また絶縁膜 2 2 は正孔輸送層 5 の下であって基板 1 上に配置される。第 1 のバンク 9 は、絶縁膜 2 2 上に配置される。

【 0 1 1 0 】

[実施の形態 5]

実施の形態 4 では、第 2 のバンクを有しない有機 E L ディスプレイパネルについて説明した。実施の形態 5 では、正孔輸送層がライン形成され、第 2 のバンクを有する有機 E L ディスプレイパネルを説明する。また、本実施の形態の有機 E L ディスプレイパネルはパッシブマトリクス型である。

【 0 1 1 1 】

本実施の形態の有機 E L ディスプレイパネルの平面図は実施の形態 2 と同じである。したがって図 3 は本実施の有機 E L ディスプレイパネルの平面図でもある。

【 0 1 1 2 】

図 7 A には、図 3 に示された本実施の形態の有機 E L ディスプレイパネルの線 A - A の断面図が示される。図 7 B には、図 3 に示された本実施の形態の有機 E L ディスプレイパネルの線 B - B の断面図が示される。

【 0 1 1 3 】

図 7 A および図 7 B に示されるように、本実施の形態の有機 E L ディスプレイパネルは、アノード電極 3 ' および第 2 のバンク 1 1 を有することならびに絶縁膜 2 2 を有しないこと以外は実施の形態 4 の有機 E L ディスプレイパネルと同じである。したがって、実施の形態 1 の有機 E L ディスプレイパネルと同一の部材については同一の符号を付して説明を省略する。

【 0 1 1 4 】

図 7 A および図 7 B に示されるように、基板 1 上にライン状のアノード電極 3 ' が配置される。正孔輸送層 5 は、画素領域 1 7 内のアノード電極 3 ' 上に形成（ライン形成）される。中間層 7 上には第 2 のバンク 1 1 が配置され副画素領域を規定する。第 1 のバンク 9 の頂点は、第 2 のバンク 1 1 の頂点よりも、基板 1 から高い。その高さの差は、例えば $1\text{ }\mu\text{m}$ 以上 $10\text{ }\mu\text{m}$ 以下である。また、第 2 のバンク 1 1 は、中間層 7 との密着性を考慮して、ある程度の濡れ性を有することが好ましい。

【 0 1 1 5 】

高分子有機 E L 材料 1 3 は、副画素領域 1 9 内にパターンニングされているか、または画素領域 1 7 にパターンニングされている。

【 0 1 1 6 】

図 7 B に示されるように、第 2 のバンク 1 1 の（図中左右の）両端よりも、内部の第 2 のバンク 1 1 は低くされている。内部の第 2 のバンク 1 1 は溝 2 1（図 3 参照）に対応している。内部の第 2 のバンク 1 1（溝 2 1）を覆うようにして、高分子有機 E L 材料 1 3 の層が配置されている。つまり、溝 2 1 は、隣接する副画素領域 1 9 同士を連通させている。第 1 のバンク 9 で規定された画素領域 1 7 に、高分子有機 E L 材料を含むポリマーインクを塗布した場合に、副画素領域 1 9 が互いに連通することなく独立していると、各副画素領域 1 9 に形成される高分子有機 E L 層 1 3 の厚さが一定となりにくい。一方、溝 2 1 を設けておくと、画素領域 1 7 に塗布されたポリマーインクが、副画素領域 1 9 同士を移動できるので、高分子有機 E L 層 1 3 の厚さが平準化される。

【 0 1 1 7 】

[実施の形態 6]

10

20

30

40

50

図 8 には、実施の形態 5 と同様に、正孔輸送層 5 および中間層 7 のいずれもが各画素領域 17 上にライン形成されている。本形態は、画素領域 17 を規定する第 1 のバンク 9 が逆テーパ形状に成形されていることを特徴とする。逆テーパ形状とすることにより、第 1 のバンク 9 がカソードセパレータとしてより有効に作用し、蒸着法により有機 EL 層 13 のそれぞれに形成されたカソード電極が互いに通電することを、より確実に防止することができる。

【 0 1 1 8 】

本出願は、2007 年 5 月 30 日出願の特願 2007 - 143906 に基づく優先権を主張する。当該出願明細書に記載された内容は、すべて本願明細書に援用される。

【産業上の利用可能性】

10

【 0 1 1 9 】

本発明の有機 EL ディスプレイパネルは、それに含まれる高分子有機 EL 層をインクジェット法などにより形成することができ、かつ正孔輸送層などをスピコート法などにより形成することができるので、その製造プロセスが簡便である。さらに、高分子有機 EL 層の厚さが一定となるので発光特性も向上する。よって、従来よりも高性能なディスプレイパネルが効率よく製造される。

【 0 1 2 0 】

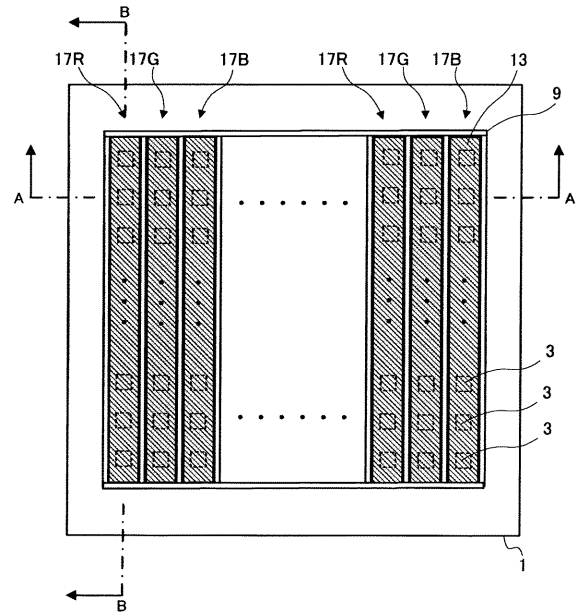
[符号の説明]

- 1 基板
- 3、3' アノード電極
- 5 正孔輸送層
- 7 中間層
- 9 第 1 のバンク
- 11 第 2 のバンク
- 13 高分子有機 EL 層
- 15 カソード電極
- 17 画素領域
- 19 副画素領域
- 21 溝
- 22 無機絶縁膜
- 23 コンタクトホール

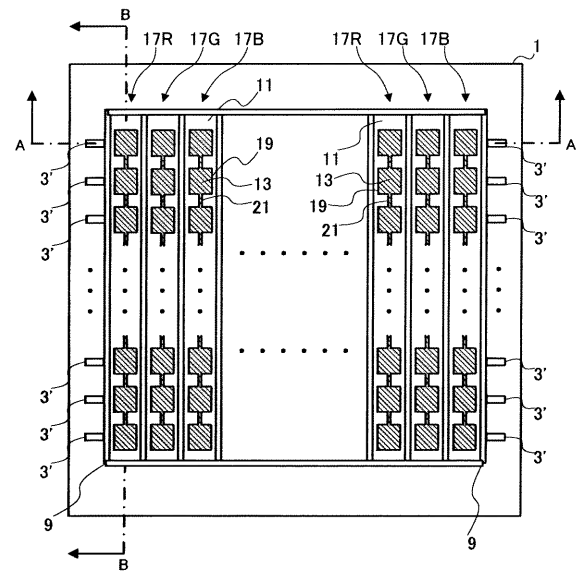
20

30

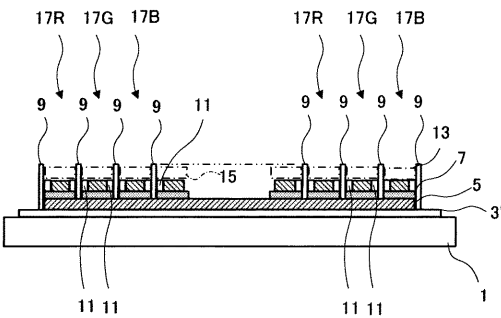
【 図 1 B 】



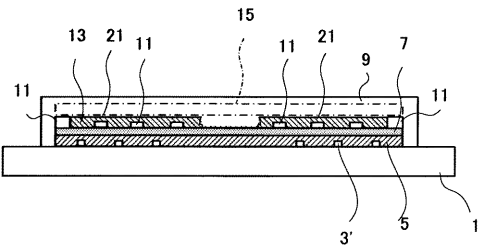
【圖 3】



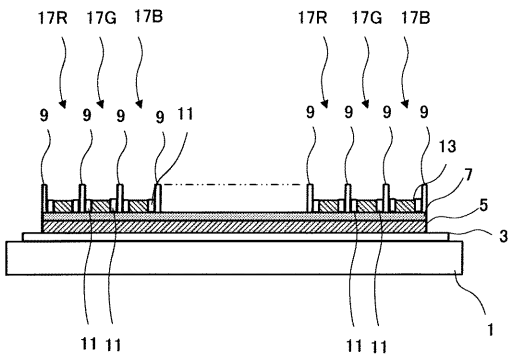
【図 4 A】



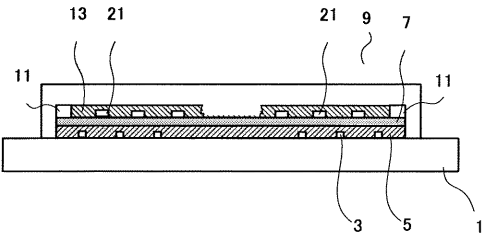
【図 4 B】



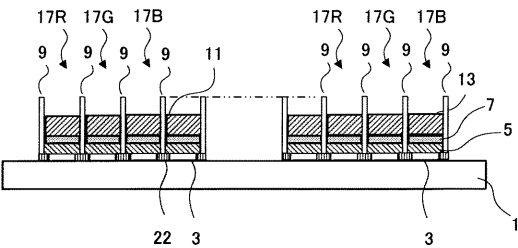
【図 5 A】



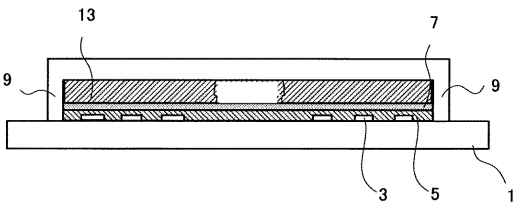
【図 5 B】



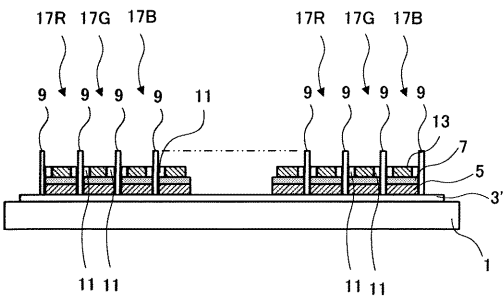
【図 6 A】



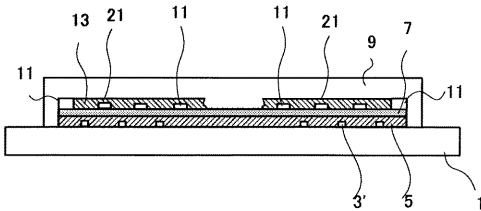
【図 6 B】



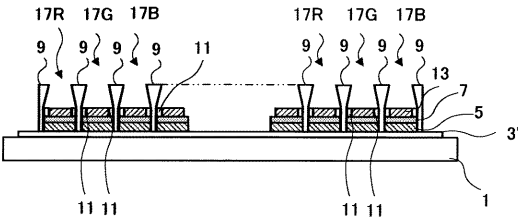
【図 7 A】



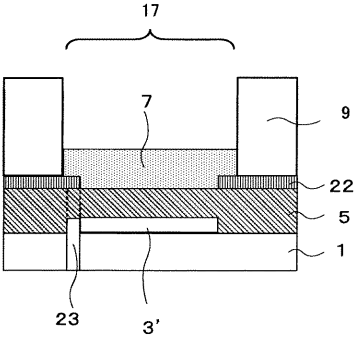
【図 7 B】



【図 8】



【図 9】



【図 1 0】

図10A

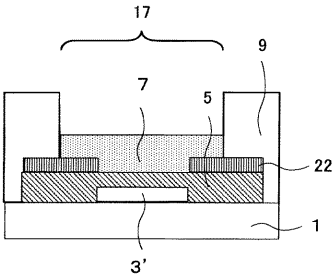


図10B

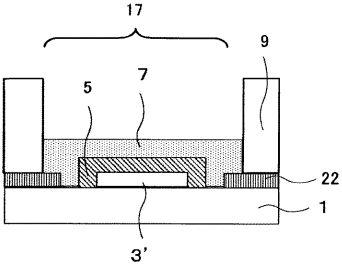
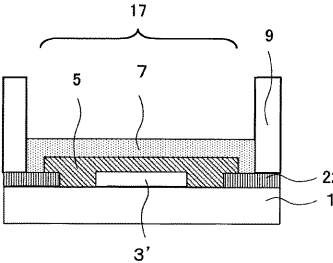
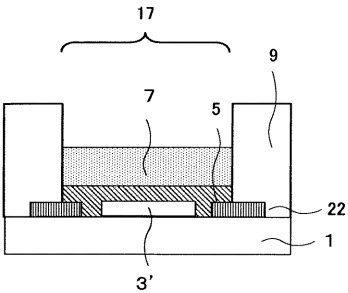


図10C



【図 1 1】



【手続補正書】

【提出日】平成20年10月8日(2008.10.8)

【手続補正 1】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】全文

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項 1】

基板上に配置されたアノード電極；

前記アノード電極が配置された基板面に設けられた正孔輸送層；

前記正孔輸送層上に設けられ、ライン状の画素領域を規定するライン状のバンク；

前記正孔輸送層上に配置された、前記画素領域の内部に2以上の副画素領域を規定する第2のバンク；

前記画素領域内に配置されたライン状の中間層；

前記画素領域内であって、前記中間層上に配置されたライン状の高分子有機EL層；および

前記高分子有機EL層上に設けられたカソード電極；を含む有機ELディスプレイパネルであって、

前記第2のバンクは、隣接する副画素領域同士を連通する溝を有する、有機ELディスプレイパネル。

【請求項 2】

前記バンクは、フッ素樹脂を含むか、または前記バンクの表面がフッ素系ガスプラズマによりフッ素化されている、請求項1に記載の有機ELディスプレイパネル。

【請求項 3】

前記正孔輸送層の材質は、タンゲステンオキサイド(WO_x)、モリブデンオキサイド(MoO_x)、バナジウムオキサイド(VO_x)、またはこれらの組み合わせを含み、

前記ライン状のバンクから前記画素領域内にはみ出し、前記ライン状の中間層またはライン状の高分子有機EL層の底面に接する絶縁性の無機膜をさらに有する、

請求項1に記載の有機ELディスプレイパネル。

【請求項 4】

(削除)

【請求項 5】

前記アノード電極は基板上にマトリクス状に配置されているアクティブマトリクス型の請求項1に記載の有機ELディスプレイパネル。

【請求項 6】

前記高分子有機EL層は、前記画素領域に、高分子有機EL材料と溶媒とを含むインクをインクジェット、ディスペンサー、ノズルコート、凹版印刷または凸版印刷によりコートして形成される、請求項1に記載の有機ELディスプレイパネル。

【請求項 7】

前記中間層は、中間層の材料を含む溶液をスピンコート、ダイコート、またはスリットコートによりコートして形成される、請求項1に記載の有機ELディスプレイパネル。

【請求項 8】

基板上に配置されたアノード電極；

基板上に設けられ、ライン状の画素領域を規定するライン状のバンク；

前記画素領域内に配置されたライン状の正孔輸送層；

前記正孔輸送層上に配置された、前記画素領域の内部に2以上の副画素領域を規定する第2のバンク；

前記画素領域内に配置されたライン状の中間層；

前記画素領域内であって、前記中間層上に配置されたライン状の高分子有機EL層；お

10

20

30

40

50

よび

前記高分子有機 E L 層上に設けられたカソード電極；を含む有機 E L ディスプレイパネルであって、

前記第 2 のバンクは、隣接する副画素領域同士を連通する溝を有する、有機 E L ディスプレイパネル。

【請求項 9】

前記バンクは、フッ素樹脂を含むか、または前記バンクの表面がフッ素系ガスプラズマによりフッ素化されている、請求項 8 に記載の有機 E L ディスプレイパネル。

【請求項 10】

前記ライン状の正孔輸送層の材質は、タングステンオキサイド (WO_x)、モリブデンオキサイド (MoO_x)、バナジウムオキサイド (VO_x)、またはこれらの組み合わせを含み、

10

前記ライン状のバンクから前記画素領域内にはみ出し、前記ライン状の中間層またはライン状の高分子有機 E L 層の底面に接する絶縁性の無機膜をさらに有する、

請求項 8 に記載の有機 E L ディスプレイパネル。

【請求項 11】

前記ライン状の正孔輸送層の材質は、ポリエチレンジオキシチオフエンを含み、

前記ライン状のバンクから前記画素領域内にはみ出し、前記ライン状の正孔輸送層の底面に接する絶縁性の無機膜をさらに有する、

請求項 8 に記載の有機 E L ディスプレイパネル。

20

【請求項 12】

(削除)

【請求項 13】

前記アノードは基板上にマトリクス状に配置されているアクティブマトリクス型の請求項 8 に記載の有機 E L ディスプレイパネル。

【請求項 14】

前記高分子有機 E L 層は、前記画素領域に、高分子有機 E L 材料と溶媒とを含むインクをインクジェット、ディスペンサー、ノズルコート、凹版印刷または凸版印刷によりコートして形成される、請求項 8 に記載の有機 E L ディスプレイパネル。

【請求項 15】

30

前記中間層は、中間層の材料を含む溶液をスピンコート、ダイコート、またはスリットコートによりコートして形成される、請求項 10 に記載の有機 E L ディスプレイパネル。

【請求項 16】

前記正孔輸送層は、正孔輸送層の材料を含む溶液をスピンコート、ダイコート、またはスリットコートによりコートして形成される、請求項 11 に記載の有機 E L ディスプレイパネル。

【請求項 17】

基板面に第一の導電層を形成するステップ；

前記第一の導電層が形成された基板面に、正孔輸送層を形成するステップ；

前記正孔輸送層上に、ライン状の電気絶縁性の障壁を形成して、ライン状の画素領域となる領域を規定するステップ；

40

前記画素領域となる領域内に、ライン状の中間層を形成するステップ；

前記画素領域となる領域内に、高分子有機 E L 材料と溶媒を含むインクをインクジェット、ディスペンサー、ノズルコート、凹版印刷または凸版印刷によりライン状にコートして、ライン状の高分子有機 E L 層を形成するステップ；および

前記有機 E L 層に第二の導電層を形成するステップ；を含む有機 E L ディスプレイパネルの製造方法。

【請求項 18】

基板面に第一の導電層を形成するステップ；

前記第一の導電層が形成された基板面に、ライン状の電気絶縁性の障壁を形成して、ラ

50

イン状の画素領域となる領域を規定するステップ；

前記画素領域となる領域内に、ライン状の正孔輸送層を形成するステップ；

前記画素領域となる領域内に、ライン状の中間層を形成するステップ；

前記画素領域となる領域に、高分子有機 E L 材料と溶媒を含むインクをインクジェット、ディスペンサー、ノズルコート、凹版印刷または凸版印刷によりコートして、ライン状の高分子有機 E L 層を形成するステップ；および

前記有機 E L 層に第二の導電層を形成するステップ；を含む有機 E L ディスプレイパネルの製造方法。

【手続補正書】

【提出日】平成 20 年 12 月 8 日 (2008.12.8)

10

【手続補正 1】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】全文

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項 1】

基板上に配置されたアノード電極；

前記アノード電極が配置された基板面に設けられた正孔輸送層；

前記正孔輸送層上に設けられ、ライン状の画素領域を規定するライン状のバンク；

20

前記正孔輸送層上に配置された、前記画素領域の内部に 2 以上の副画素領域を規定する第 2 のバンク；

前記画素領域内に配置されたライン状の中間層；

前記画素領域内であって、前記中間層上に配置されたライン状の高分子有機 E L 層；および

前記高分子有機 E L 層上に設けられたカソード電極；を含む有機 E L ディスプレイパネルであって、

前記第 2 のバンクは、隣接する副画素領域同士を連通する溝を有する、有機 E L ディスプレイパネル。

【請求項 2】

30

前記バンクは、フッ素樹脂を含むか、または前記バンクの表面がフッ素系ガスプラズマによりフッ素化されている、請求項 1 に記載の有機 E L ディスプレイパネル。

【請求項 3】

前記正孔輸送層の材質は、タングステンオキシド (WO_x)、モリブデンオキシド (MoO_x)、バナジウムオキシド (VO_x)、またはこれらの組み合わせを含み、

前記ライン状のバンクから前記画素領域内にはみ出し、前記ライン状の中間層またはライン状の高分子有機 E L 層の底面に接する絶縁性の無機膜をさらに有する、

請求項 1 に記載の有機 E L ディスプレイパネル。

【請求項 4】

前記アノード電極は基板上にマトリクス状に配置されているアクティブマトリクス型の請求項 1 に記載の有機 E L ディスプレイパネル。

40

【請求項 5】

前記高分子有機 E L 層は、前記画素領域に、高分子有機 E L 材料と溶媒とを含むインクをインクジェット、ディスペンサー、ノズルコート、凹版印刷または凸版印刷によりコートして形成される、請求項 1 に記載の有機 E L ディスプレイパネル。

【請求項 6】

前記中間層は、中間層の材料を含む溶液をスピンコート、ダイコート、またはスリットコートによりコートして形成される、請求項 1 に記載の有機 E L ディスプレイパネル。

【請求項 7】

基板上に配置されたアノード電極；

50

基板上に設けられ、ライン状の画素領域を規定するライン状のバンク；

前記画素領域内に配置されたライン状の正孔輸送層；

前記正孔輸送層上に配置された、前記画素領域の内部に２以上の副画素領域を規定する第２のバンク；

前記画素領域内に配置されたライン状の中間層；

前記画素領域内であって、前記中間層上に配置されたライン状の高分子有機ＥＬ層；および

前記高分子有機ＥＬ層上に設けられたカソード電極；を含む有機ＥＬディスプレイパネルであって、

前記第２のバンクは、隣接する副画素領域同士を連通する溝を有する、有機ＥＬディスプレイパネル。

10

【請求項８】

前記バンクは、フッ素樹脂を含むか、または前記バンクの表面がフッ素系ガスプラズマによりフッ素化されている、請求項７に記載の有機ＥＬディスプレイパネル。

【請求項９】

前記ライン状の正孔輸送層の材質は、タンゲステンオキサイド（ WO_x ）、モリブデンオキサイド（ MoO_x ）、バナジウムオキサイド（ VO_x ）、またはこれらの組み合わせを含み、

前記ライン状のバンクから前記画素領域内にはみ出し、前記ライン状の中間層またはライン状の高分子有機ＥＬ層の底面に接する絶縁性の無機膜をさらに有する、

20

請求項７に記載の有機ＥＬディスプレイパネル。

【請求項１０】

前記ライン状の正孔輸送層の材質は、ポリエチレンジオキシチオフエンを含み、

前記ライン状のバンクから前記画素領域内にはみ出し、前記ライン状の正孔輸送層の底面に接する絶縁性の無機膜をさらに有する、

請求項７に記載の有機ＥＬディスプレイパネル。

【請求項１１】

前記アノードは基板上にマトリクス状に配置されているアクティブマトリクス型の請求項７に記載の有機ＥＬディスプレイパネル。

【請求項１２】

30

前記高分子有機ＥＬ層は、前記画素領域に、高分子有機ＥＬ材料と溶媒とを含むインクをインクジェット、ディスペンサー、ノズルコート、凹版印刷または凸版印刷によりコートして形成される、請求項７に記載の有機ＥＬディスプレイパネル。

【請求項１３】

前記中間層は、中間層の材料を含む溶液をスピンコート、ダイコート、またはスリットコートによりコートして形成される、請求項９に記載の有機ＥＬディスプレイパネル。

【請求項１４】

前記正孔輸送層は、正孔輸送層の材料を含む溶液をスピンコート、ダイコート、またはスリットコートによりコートして形成される、請求項１０に記載の有機ＥＬディスプレイパネル。

40

【請求項１５】

基板面に第一の導電層を形成するステップ；

前記第一の導電層が形成された基板面に、正孔輸送層を形成するステップ；

前記正孔輸送層上に、ライン状の電気絶縁性の障壁を形成して、ライン状の画素領域となる領域を規定するステップ；

前記画素領域となる領域内に、ライン状の中間層を形成するステップ；

前記画素領域となる領域内に、高分子有機ＥＬ材料と溶媒を含むインクをインクジェット、ディスペンサー、ノズルコート、凹版印刷または凸版印刷によりライン状にコートして、ライン状の高分子有機ＥＬ層を形成するステップ；および

前記有機ＥＬ層に第二の導電層を形成するステップ；を含む有機ＥＬディスプレイパネ

50

ルの製造方法。

【請求項 16】

基板面に第一の導電層を形成するステップ；

前記第一の導電層が形成された基板面に、ライン状の電気絶縁性の障壁を形成して、ライン状の画素領域となる領域を規定するステップ；

前記画素領域となる領域内に、ライン状の正孔輸送層を形成するステップ；

前記画素領域となる領域内に、ライン状の中間層を形成するステップ；

前記画素領域となる領域に、高分子有機 E L 材料と溶媒を含むインクをインクジェット、ディスペンサー、ノズルコート、凹版印刷または凸版印刷によりコートして、ライン状の高分子有機 E L 層を形成するステップ；および

前記有機 E L 層に第二の導電層を形成するステップ；を含む有機 E L ディスプレイパネルの製造方法。

【手続補正 2】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】全文

【補正方法】変更

【補正の内容】

【発明の詳細な説明】

【技術分野】

【0001】

本発明は、有機 E L ディスプレイパネルおよびその製造方法に関する。

【背景技術】

【0002】

有機 E L ディスプレイパネルとは、有機化合物の電界発光を利用した発光素子を利用したディスプレイパネルである。つまり有機 E L ディスプレイパネルは、陰極および陽極、ならびに両極の間に配置された電界発光する有機化合物を含む E L 素子を有する。電界発光する有機化合物は、低分子有機化合物の組み合わせ（ホスト材料とドーパント材料）と、高分子有機化合物とに大別されうる。電界発光する高分子有機化合物の例には、P P V と称されるポリフェニレンビニレンやその誘導体などが含まれる。電界発光する高分子有機化合物を利用した有機 E L ディスプレイパネルは、比較的低電圧で駆動でき、消費電力が少なく、ディスプレイパネルの大画面化に対応しやすいと言われており、積極的に研究が行なわれている。

【0003】

電界発光する高分子有機化合物は、その発光する光の色（R，GまたはB）に応じて、各画素にインクジェットなどの印刷技術を用いて配置される。例えば、高分子有機化合物と溶媒を含むポリマーインクを、インクジェットヘッドから吐出して印刷する。各画素に電界発光する高分子有機化合物を含むインクを印刷するときに、隣り合う画素にポリマーインクが浸入しないようにする必要がある。

【0004】

隣り合う画素にポリマーインクが浸入しないようにするため、以下の2つの方法が採用されている。

第一は、画素に含まれる各副画素を規定する隔壁を設けて、各副画素だけに正確にポリマーインクを正確に滴下することによって、隣り合う画素へのインクの浸入を抑制する。

第二は、ライン状に配列された各画素を規定する障壁と、各画素の領域において副画素を規定する障壁とを設けて、各画素の領域全体（副画素と副画素の間の領域を含む）にポリマーインクを塗る場合に、各画素を規定する障壁を、副画素を規定する障壁よりも高くして、隣接する画素へのポリマーインクの浸入を抑制する（例えば、特許文献1および特許文献2を参照）。

【0005】

第一の方法のように各副画素にポリマーインクを滴下するよりも、第二の方法のように

複数の副画素を含む画素全体にポリマーインクを塗れば、全ての副画素に簡便かつ迅速にポリマーインクを提供することができる。しかしながら、第二の方法により画素に提供されたポリマーインクから作製される有機発光層の厚さは均一になりにくい。

【特許文献１】米国特許第６３８８３７７号明細書

【特許文献２】米国特許第７０９１６６０号明細書

【発明の開示】

【発明が解決しようとする課題】

【０００６】

本発明者は、ライン状に配列した画素領域（複数の副画素を含む領域）に、電界発光する高分子有機化合物を含むポリマーインクを塗布して有機発光層を作製するステップを含む有機ＥＬディスプレイパネルの製造方法であって、より簡便な方法を検討した。それにより塗布されたポリマーインクから作製される有機発光層の厚さが不均一になる理由の一つが、その下地となる正孔輸送層または中間層の厚さが不均一であることを見出した。

10

【０００７】

正孔輸送層や中間層の厚さが不均一となる理由は、画素領域を規定する障壁と、副画素領域を規定する障壁とを形成し；形成された障壁によって規定された領域内に正孔輸送層や中間層を形成するためである。つまり複雑な構造の障壁の内部に、正孔輸送層や中間層を形成していたことが一因であることがわかった。

【課題を解決するための手段】

【０００８】

本発明者は、正孔輸送層や中間層を副画素ごとに独立して設けることなく、それらを複数の副画素で共有しても、有機ＥＬディスプレイが適切に動作することを見出した。

20

【０００９】

そこで、アノード電極が形成された基板面に、正孔輸送層または中間層を作製し；作製した正孔輸送層または中間層の上に、ライン状に配列した画素領域を規定する障壁と、必要に応じて各副画素を規定する障壁とを設け；さらに電界発光する高分子有機化合物を含むポリマーインクをライン状の画素領域全体に塗布して、均一な厚さを有する有機ＥＬ層を得ることを検討した。

さらに、アノード電極を形成した基板面にライン状に配列した画素領域を規定する障壁を設け；ライン状の画素領域上に正孔輸送層または中間層を作製し；正孔輸送層または中間層に各副画素を規定する障壁を設け；さらに電界発光する高分子有機化合物を含むポリマーインクをライン状の画素領域全体に塗布して、均一な厚さを有する有機ＥＬ層を得ることを検討した。

30

【００１０】

これらの手順によれば、複数の画素領域を含む基板全体、または複数の副画素領域を含む画素領域全体に、正孔輸送層または中間層を、いわゆる「べた塗り」することができるので、一定の厚さの正孔輸送層または中間層を得ることができる。「べた塗り」とは、スピンコート、ダイコート、スリットコートなどの手法による塗布を意味する。一定の厚さの正孔輸送層または中間層を作製することができるので、有機ＥＬ層の厚さも均一になりやすい。

40

【００１１】

すなわち本発明の第一は、以下に示す有機ＥＬディスプレイパネルに関する。

〔１〕 基板の上に配置されたアノード電極；前記アノード電極が配置された基板面に設けられた正孔輸送層；前記正孔輸送層上に設けられ、ライン状の画素領域を規定するライン状のバンク；前記画素領域内に配置されたライン状の中間層；前記画素領域内であって、前記中間層上に配置されたライン状の高分子有機ＥＬ層；および、前記高分子有機ＥＬ層上に設けられたカソード電極；を含む有機ＥＬディスプレイパネル。

〔２〕 前記バンクは、フッ素樹脂を含むか、または前記バンクの表面がフッ素系ガスプラズマによりフッ素化されている、〔１〕に記載の有機ＥＬディスプレイパネル。

〔３〕 前記正孔輸送層の材質は、タンゲステンオキサイド（ WO_x ）、モリブデンオ

50

キサイド (MoO_x)、バナジウムオキサイド (VO_x)、またはこれらの組み合わせを含み、前記ライン状のバンクから前記画素領域内にはみ出し、前記ライン状の中間層またはライン状の高分子有機 EL 層の底面に接する絶縁性の無機膜をさらに有する、[1] または [2] に記載の有機 EL ディスプレイパネル。

[4] 基板上に配置されたアノード電極；基板上に設けられ、ライン状の画素領域を規定するライン状のバンク；前記画素領域内に配置されたライン状の正孔輸送層；前記画素領域内に配置されたライン状の中間層；前記画素領域内であって、前記中間層上に配置されたライン状の高分子有機 EL 層；および、前記高分子有機 EL 層上に設けられたカソード電極；を含む有機 EL ディスプレイパネル。

[5] 前記バンクは、フッ素樹脂を含むか、または前記バンクの表面がフッ素系ガスプラズマによりフッ素化されている、[4] に記載の有機 EL ディスプレイパネル。

[6] 前記ライン状の正孔輸送層の材質は、タングステンオキサイド (WO_x)、モリブデンオキサイド (MoO_x)、バナジウムオキサイド (VO_x)、またはこれらの組み合わせを含み、前記ライン状のバンクから前記画素領域内にはみ出し、前記ライン状の中間層またはライン状の高分子有機 EL 層の底面に接する絶縁性の無機膜をさらに有する、[4] または [5] に記載の有機 EL ディスプレイパネル。

[7] 前記ライン状の正孔輸送層の材質は、ポリエチレンジオキシチオフエンを含み、前記ライン状のバンクから前記画素領域内にはみ出し、前記ライン状の正孔輸送層の底面に接する絶縁性の無機膜をさらに有する、[4] または [5] に記載の有機 EL ディスプレイパネル。

【 0 0 1 2 】

さらに本発明の第二は、以下に示す有機 EL ディスプレイパネルの製造方法に関する。

[8] 基板面に第一の導電層を形成するステップ；前記第一の導電層が形成された基板面に、正孔輸送層を形成するステップ；前記正孔輸送層上に、ライン状の電気絶縁性の障壁を形成して、ライン状の画素領域となる領域を規定するステップ；前記画素領域となる領域内に、ライン状の中間層を形成するステップ；前記画素領域となる領域内に、高分子有機 EL 材料と溶媒を含むインクをインクジェット、ディスペンサー、ノズルコート、凹版印刷または凸版印刷によりライン状にコートして、ライン状の有機 EL 層を形成するステップ；および、前記高分子有機 EL 層に第二の導電層を形成するステップ；を含む有機 EL ディスプレイパネルの製造方法。

[9] 基板面に第一の導電層を形成するステップ；前記第一の導電層が形成された基板面に、ライン状の電気絶縁性の障壁を形成して、ライン状の画素領域となる領域を規定するステップ；前記画素領域となる領域内に、ライン状の正孔輸送層を形成するステップ；前記画素領域となる領域内に、ライン状の中間層を形成するステップ；前記画素領域となる領域内に、高分子有機 EL 材料と溶媒を含むインクをインクジェット、ディスペンサー、ノズルコート、凹版印刷または凸版印刷によりコートして、ライン状の有機 EL 層を形成するステップ；および、前記高分子有機 EL 層に第二の導電層を形成するステップ；を含む有機 EL ディスプレイパネルの製造方法。

【 発明の効果 】

【 0 0 1 3 】

本発明の高分子有機 EL ディスプレイパネルは、カソード電極とアノード電極に挟まれる各機能層（高分子有機 EL 層など）の厚さが均一となりうるので、従来のディスプレイパネルよりも発光特性が改善される。また、カソード電極とアノード電極に挟まれる各機能層のうち、高分子有機 EL 層を除く正孔輸送層や中間層を、いわゆる「ベタ塗り」することができるので、高分子有機 EL ディスプレイパネルの製造プロセスが簡略化される。

【 発明を実施するための最良の形態 】

【 0 0 1 4 】

1. 本発明の有機 EL ディスプレイパネルについて

本発明の有機 EL ディスプレイパネルは、基板、アノード電極、カソード電極、ならびに両電極に挟まれた正孔輸送層、中間層および発光層を有する有機 EL 素子を有する。ま

た、本発明の有機ＥＬディスプレイパネルは第１のバンクを有する。

【００１５】

本発明の有機ＥＬディスプレイパネルは発光層として高分子有機ＥＬ材料を用いることが好ましい。さらに有機ＥＬ素子を駆動するための薄膜トランジスタ（駆動ＴＦＴ）を有し、有機ＥＬ素子のアノード電極と、駆動ＴＦＴのソースまたはドレイン電極とが接続されている。

【００１６】

本発明の有機ＥＬディスプレイパネルは、有機ＥＬ素子の構造、特に各機能層の配置に特徴があるが、他の構成は、本発明の効果を損なわない限り公知の有機ＥＬディスプレイパネルと同様にされうる。

例えば、本発明の有機ＥＬディスプレイパネルは、アノード電極がライン状に配置されるパッシブマトリクス型か、またはアノード電極がマトリクス状に配置されるアクティブマトリクス型のいずれでもよく、かつボトムエミッション型（発光した光を、アノード電極や基板を通してとりだす）でも、トップエミッション型（発光した光を、カソード電極や封止膜などを通してとりだす）のいずれでもよい。

【００１７】

本発明の有機ＥＬディスプレイパネルの基板は、ボトムエミッション型か、トップエミッション型かによって、その材質が異なる。ボトムエミッション型の場合には、基板が透明であることが求められるので、ガラスや透明樹脂などの基板であればよい。一方、トップエミッション型の場合には、基板が透明である必要はなく、その材質は絶縁性であれば任意である。

【００１８】

基板には、アノード電極が形成されている。有機ＥＬディスプレイパネルがパッシブマトリクス型である場合、アノード電極はライン状に、複数本形成される。ライン状のアノード電極は、互いに並行であることが好ましい。有機ＥＬディスプレイパネルがアクティブマトリクス型である場合、アノード電極は基板上にマトリクス状に複数個配置される。

【００１９】

有機ＥＬディスプレイパネルがボトムエミッション型の場合、アノード電極が透明電極であることが求められ、ITOなどで形成すればよい。有機ＥＬディスプレイパネルがトップエミッション型の場合には、アノード電極に光反射性が求められ、例えば銀を含む合金、より具体的には銀 - パラジウム - 銅合金（ＡＰＣとも称する）などで形成すればよい。アノード電極層は、その表面にタングステン薄膜などを有していてもよい。

【００２０】

アノード電極が形成された基板面には、正孔輸送層または中間層が形成されている。もちろん両方の層が形成されていてもよく、正孔輸送層、中間層の順に形成すればよい。また、正孔輸送層が形成されない場合もあり得る。

【００２１】

正孔輸送層とは正孔輸送材料からなる層であり、正孔輸送材料の例には、ポリエチレンスルホン酸をドーブしたポリ（３，４ - エチレンジオキシチオフエン）（PEDOT - PSSと称される）や、その誘導体（共重合体など）が含まれる。正孔輸送層の厚さは通常、１０ｎｍ以上１００ｎｍ以下であり、約３０ｎｍでありうる。また、正孔輸送層の材質は、WO_x（タングステンオキサイド）やMoO_x（モリブデンオキサイド）、VO_x（バナジウムオキサイド）などの酸化物や、これらの組み合わせなどであってもよい。

【００２２】

中間層は、正孔輸送層に電子が輸送されるのをブロックする役割や、高分子有機ＥＬ層に正孔を効率よく運ぶ役割などを有し、例えばポリアニリン系の材料からなる層である。中間層の厚さは通常、１０ｎｍ以上１００ｎｍ以下であり、約４０ｎｍでありうる。

【００２３】

上述のように本発明では、正孔輸送層または中間層を、いわゆる「ベタ塗り」によって作製することができることを特徴とする。つまり、正孔輸送層や中間層をスピンコート法

10

20

30

40

50

、ダイコート法、スリットコート法などによって容易に「面形成」または「ライン形成」でき、しかもその厚さを一定にすることができる。

【 0 0 2 4 】

ここで「面形成」とは、機能層（正孔輸送層や中間層など）をアノード電極が配置された基板面に複数の画素領域に亘って面状に形成することを意味する。また「ライン形成」とは、後述するディスプレイパネル上に形成された複数のライン状の画素領域ごとに、機能層を形成することを意味する。

【 0 0 2 5 】

本発明の有機 E L ディスプレイパネルは、発光層として高分子有機 E L 層を含むことが好ましい。有機 E L 層は、後述する第 1 のバンクで規定された画素領域内にライン形成されればよい。

10

【 0 0 2 6 】

高分子有機 E L 材料は各画素から所望の発色（レッド R , グリーン G , ブルー B ）が生じるように、適宜選択される。例えば、レッド画素の隣にグリーン画素を配置し、グリーン画素の隣にブルー画素を配置し、ブルー画素の隣にレッド画素を配置する。

【 0 0 2 7 】

高分子有機 E L 材料と溶媒を含むインクを、インクジェットなどの塗布法によって画素領域に塗布することによって、容易に、かつ他の材料に損傷を与えることなく有機 E L 層を形成することができる。高分子有機 E L 材料の例には、ポリフェニレンビニレン（Poly phenylene vinylene（PPV））およびその誘導体、ポリアセチレン（Poly acetylene）およびその誘導体、ポリフェニレン（Poly phenylene（PPP））およびその誘導体、ポリパラフェニレンエチレン（Poly para phenyleneethylene（PPV））およびその誘導体、ポリ 3 - ヘキシルチオフェン（Poly 3-hexyl thiophene（P3HT））およびその誘導体、ポリフルオレン（Poly fluorene（PF））およびその誘導体などが含まれる。また高分子有機 E L 層の厚さは約 5 0 ~ 1 0 0 n m（例えば 6 0 n m）であることが好ましい。

20

【 0 0 2 8 】

本発明の有機 E L ディスプレイは、画素領域を規定する第 1 のバンクを有する。

第 1 のバンクはライン状に複数本形成され、ライン状の画素領域を規定する。ライン状の第 1 のバンクは互いに並行であることが好ましい。また、アノード電極がライン状である場合、ライン状の第 1 のバンクのラインの方向と、アノード電極のラインの方向とは直交することが好ましい。

30

【 0 0 2 9 】

第 1 のバンクの形状は順テーパー型であっても、逆テーパー型であってもよい。第 1 のバンクが逆テーパー型である場合は、後述するように、カソード同士の通電を防止することができる。一方で第 1 のバンクが順テーパー状である場合は、第 1 のバンクが逆テーパー状である場合と比較してカソード電極を薄くすることができる。

【 0 0 3 0 】

第 1 のバンクの材質は絶縁性であれば任意であるが、絶縁性樹脂（ポリイミドなど）であることが好ましい。さらに、第 1 のバンクの表面は濡れ性が低い（例えば撥水性である）ことが好ましい。第 1 のバンクの水に対する接触角は、例えば 6 0 ° 以上である。そのため、第 1 のバンクの材質はフッ素樹脂を含む絶縁性樹脂であることが好ましい。または第 1 のバンクの表面を、フッ素系ガスプラズマでフッ素化することにより、濡れ性を低下させてもよい。

40

【 0 0 3 1 】

第 1 のバンクは、露光・現像プロセスを含むフォトリソグラフィ法によって形成してもよいが、凹版印刷などによって形成してもよい。凹版印刷などで形成すれば、他の材質（正孔輸送層など）に損傷を与えにくい。

【 0 0 3 2 】

第 1 のバンクは、画素領域を規定するとともに、カソードセパレータとしても機能する。カソードセパレータとは、カソード電極（後述）を分離するための部材であって、例

50

えば蒸着により有機 E L 層上に形成されたカソード電極を、ライン状の画素領域ごとに分割する。

【 0 0 3 3 】

本発明の有機 E L ディスプレイパネルは、高分子有機 E L 層上にカソード電極層を有する。カソード電極層の材質は、ボトムエミッション型か、トップエミッション型かによって、その材質が異なる。トップエミッション型の場合にはカソード電極が透明である必要があるので、ITO 電極やIZO 電極などを形成することが好ましい。高分子有機 E L 層とカソード電極層との間にはバッファ層等が形成されることが好ましい。一方、ボトムエミッション型の場合にはカソード電極が透明である必要はなく、任意の材質の電極を用いればよい。

10

【 0 0 3 4 】

カソード電極は、各画素領域に配置された有機 E L 層上に形成されていればよいが、通常は画素領域全体を覆うように形成されている（図 1 A 参照）。通常は、互いに隣接する画素領域に形成されたカソード電極同士が通電しないように、第 1 のバンクがカソードセパレータとなる。カソード電極は通常、蒸着法により形成されるので、第 1 のバンクの形状を逆テーパ形状にすれば（図 8 参照）、より確実に隣接するカソード電極同士の通電を防止できる。さらにカソード電極は、画素領域ごとに分離されていなくてもよい場合がある。つまり、アクティブマトリクス型のようにアノード電極が画素電極ごとに独立して制御されていれば、画素電極をドライブする TFT 素子が独立しているので、カソード電極を複数の画素領域で共有することができる。

20

【 0 0 3 5 】

本発明の有機 E L ディスプレイパネルに、さらにカソード電極を形成した面にカバー材を設けて封止してもよい。カバー材により水分や酸素の浸入を抑制する。

【 0 0 3 6 】

本発明の有機 E L ディスプレイパネルは電気絶縁性の無機膜（以下「無機絶縁膜」という）をさらに有していてもよい。無機絶縁膜は電気絶縁性であることはもちろんであるが、濡れ性が高いことも好ましい。無機絶縁膜の材質の例にはシリコンオキサイド（ SiO_2 ）やシリコンナイトライド（ Si_3N_4 ）、シリコンオキシナイトライド（ SiON ）などが含まれる。無機絶縁膜の厚さは 10 nm ~ 200 nm であることが好ましい。

【 0 0 3 7 】

無機絶縁膜はバンクから画素領域まではみ出していることが好ましい（図 9、図 10 および図 11 参照）。好ましくは、無機絶縁膜はバンクから画素領域まで 5 ~ 10 μm はみ出している。

30

【 0 0 3 8 】

バンクからはみ出した無機絶縁膜上に機能層（高分子有機 E L 層、正孔輸送層または中間層）の材料を含む溶液を塗布する。無機絶縁膜により溶液は画素領域全体に均一に塗布され、膜厚が均一な機能層を得ることができる。

【 0 0 3 9 】

また、図 9 のように無機絶縁膜 22 が副画素領域 17 まではみ出していることで、コンタクトホール 23 から注入された正孔が高分子有機 E L 層に浸入することが防止される。これにより、コンタクトホールのように発光が予定されない箇所が発光することが防止される。

40

【 0 0 4 0 】

前述の通り本発明有機 E L ディスプレイパネルは、第 1 のバンクと第 1 のバンクからはみ出した無機絶縁膜（任意）とを有するが、第 1 のバンクおよび無機絶縁膜の態様（形状および配置位置）は、正孔輸送層および中間層の態様に応じて、以下の 3 つの態様に分別されうる。以下、第 1 のバンクおよび絶縁性の無機膜の形状ならびに配置位置について、3 つの態様に分けて説明する。

【 0 0 4 1 】

（ 1 ）正孔輸送層が面形成される場合（図 2、図 4、図 5 および図 9 参照）

50

正孔輸送層

本態様では、正孔輸送層は、面形成される。本態様では正孔輸送層の材質はタングステンオキサイドなどの酸化物であることが好ましい。

【0042】

中間層

本態様では、中間層は、正孔輸送層上の第1のバンクによって規定されたライン状の画素領域内に形成（ライン形成）されるか、正孔輸送層上に面形成される。好ましくは、中間層はライン形成される。

【0043】

第1のバンク

本態様では第1のバンクは、面形成された正孔輸送層または中間層上に形成され、高分子有機EL層の領域または中間層および高分子有機EL層の領域を規定する（図2、図4、図5、および図9参照）。つまり、1）中間層が面形成される場合、第1のバンクは中間層上に形成され、高分子有機EL層の領域を規定し（図5参照）、2）中間層がライン形成される場合、第1のバンクは正孔輸送層上に形成され、中間層および高分子有機EL層の領域を規定する（図2、図4および図9参照）。

好ましくは、第1のバンクは正孔輸送層上に形成され、ライン形成された中間層および高分子有機EL層の領域を規定する（図2、図4および図9参照）。

【0044】

高分子有機EL層

高分子有機EL層は、第1のバンクによって規定されたライン状の画素領域内であって中間層上に形成（ライン形成）される。

【0045】

無機絶縁膜

本態様では無機絶縁膜は、中間層または高分子有機EL層の底面に接するように正孔輸送層上または中間層上に形成される（図9参照）。つまり、1）中間層が面形成される場合、無機絶縁膜は、高分子有機EL層の底面に接するように中間層上に形成され、2）中間層がライン形成される場合、無機絶縁膜は、中間層の底面に接するように正孔輸送層上に形成される（図9参照）。

好ましくは、無機絶縁膜は、中間層の底面に接するように正孔輸送層上に形成される（図9参照）。無機絶縁膜が中間層の底面に接するように正孔輸送層上に配置されることで、第1のバンクで規定された画素領域内に中間層の材料を含む溶液を塗布して中間層をライン形成する場合、中間層の膜厚をより均一にすることができる（図9参照）。

【0046】

本態様の有機ELディスプレイパネルは、1）正孔輸送層（面形成）、2）中間層（面形成）、3）第1のバンク、4）高分子有機EL層（ライン形成）の順で製造してもよいし、1）正孔輸送層（面形成）、2）第1のバンク、3）中間層（ライン形成）、4）高分子有機EL層（ライン形成）の順で製造してもよい。

好ましくは、本態様の有機ELディスプレイパネルは、1）正孔輸送層（面形成）、2）第1のバンク、3）中間層（ライン形成）、4）高分子有機EL層（ライン形成）の順で製造される。

【0047】

（2）正孔輸送層がライン形成され、正孔輸送層の材質がタングステンオキサイドなどの酸化物である場合（図10参照）

正孔輸送層

本態様では、正孔輸送層の材質はタングステンオキサイドなどの酸化物である。正孔輸送層は、後述する第1のバンクによって規定される領域内に位置するようにライン形成される。正孔輸送層はアノード電極を覆うように形成されることが好ましい。

【0048】

中間層

10

20

30

40

50

本態様では、中間層は、第1のバンクによって規定されたライン状の画素領域内に形成（ライン形成）されるか、正孔輸送層および基板上に面形成される。好ましくは、中間層はライン形成される。

【0049】

第1のバンク

本態様では第1のバンクは、基板上（図10参照）または中間層上に形成され、高分子有機EL層の領域または中間層および高分子有機EL層の領域を規定する。つまり、1）中間層が面形成される場合、第1のバンクは中間層上に形成され、高分子有機EL層の領域を規定し、2）中間層がライン形成される場合、第1のバンクは基板上に形成され、中間層および高分子有機EL層の領域を規定する。

10

好ましくは、第1のバンクは基板上に形成され（図10参照）、ライン形成された中間層および高分子有機EL層の領域を規定する。

【0050】

高分子有機EL層

高分子有機EL層は、第1のバンクによって規定されたライン状の画素領域内であって中間層上に形成（ライン形成）される。

【0051】

無機絶縁膜

本態様では無機絶縁膜は、中間層または高分子有機EL層の底面に接するように形成される（図10参照）。つまり、1）中間層が面形成される場合、無機絶縁膜は、高分子有機EL層の底面に接するように中間層上に形成され、2）中間層がライン形成される場合、無機絶縁膜は、中間層の底面に接するように形成される（図10参照）。

20

好ましくは、無機絶縁膜は、中間層の底面に接するように形成される（図10参照）。無機絶縁膜は、中間層の底面に接するように形成されるのであれば、正孔輸送層上に配置されてもよいし（図10A）、基板上に配置されてもよいし（図10B）、基板上であって正孔輸送層の下に配置されてもよい（図10C）。無機絶縁膜が中間層の底面に接するように形成されることで、第1のバンクで規定された画素領域内に中間層の材料を含む溶液を塗布して中間層をライン形成する場合、中間層の膜厚をより均一にすることができる（図10参照）。また、第1のバンクと正孔輸送層との間に無機絶縁膜が配置されることで（図10A）、第1のバンクと酸化物からなる正孔輸送層との接着性が高まる。

30

【0052】

本態様の有機ELディスプレイパネルは、1）正孔輸送層（ライン形成）、2）中間層（面形成）、3）第1のバンク、4）高分子有機EL層（ライン形成）の順で製造してもよいし、1）正孔輸送層（ライン形成）、2）第1のバンク、3）中間層（ライン形成）、4）高分子有機EL層（ライン形成）の順で製造してもよい。

好ましくは、本態様の有機ELディスプレイパネルは、1）正孔輸送層（ライン形成）、2）第1のバンク、3）中間層（ライン形成）、4）高分子有機EL層（ライン形成）の順で製造される。

【0053】

（3）正孔輸送層がライン形成され、正孔輸送層の材質がPEDOT-SSである場合（図11参照）

40

正孔輸送層

本態様では、正孔輸送層は後述する第1のバンクによって規定されるライン状の画素領域内にPEDOT-SSを塗布することでライン形成される。

【0054】

中間層

本態様では、中間層は、第1のバンクによって規定されたライン状の画素領域内であって正孔輸送層上に形成（ライン形成）される。

【0055】

高分子有機EL層

50

高分子有機 E L 層は、第 1 のバンクによって規定されたライン状の画素領域内であって中間層上に形成（ライン形成）される。

【 0 0 5 6 】

第 1 のバンク

本態様では、第 1 のバンクは基板面に形成され、正孔輸送層、中間層および高分子有機 E L 層の領域を規定する（図 1 1 参照）。

【 0 0 5 7 】

無機絶縁膜

本態様における無機絶縁膜は正孔輸送層の底面に接するように基板上に配置される（図 1 1 参照）。無機絶縁膜が正孔輸送層の底面に接するように形成されることで、P E D O T - P S S を材料とする正孔輸送層の膜厚をより均一にすることができる。

【 0 0 5 8 】

本態様の有機 E L ディスプレイパネルは、1) 第 1 のバンク、2) 正孔輸送層（ライン形成）、3) 中間層（ライン形成）、4) 高分子有機 E L 層（ライン形成）の順で製造されることが好ましい。

【 0 0 5 9 】

このように本発明の有機 E L ディスプレイパネルは正孔輸送層および中間層の態様（形状および材質）によって、第 1 のバンク、および無機絶縁膜層の配置位置が異なる。一方で高分子有機 E L 層、カソード電極および後述する第 2 のバンクの配置位置は、上記 3 つの態様において共通する。

【 0 0 6 0 】

本発明の有機 E L ディスプレイパネルは、さらに第 2 のバンクを有していてもよい。

第 2 のバンクは画素領域内に 2 以上の副画素領域を規定する。第 2 のバンクは正孔輸送層上に配置されていてもよく、または中間層上に配置されていてもよい。第 2 のバンクが正孔輸送層上に配置された場合、中間層および高分子有機 E L 層が第 2 のバンクによって規定される。一方、第 2 のバンクが中間層上に配置された場合、高分子有機 E L 層が第 2 のバンクによって規定される。

第 2 のバンクは、好ましくは正孔輸送層上に配置され、中間層および高分子有機 E L 層を規定する。

【 0 0 6 1 】

第 2 のバンクの材料は、第 1 のバンクと同様に絶縁性であれば特に限定されないが、絶縁性樹脂であることが好ましい。第 2 のバンクにより画素間の電氣的なクロストークを抑制することができる。さらに第 2 のバンクの材料は、黒色であることが好ましい。第 2 のバンクは副画素領域を規定するので、副画素領域から発せられる光とのコントラストの高い色のバンクとすることにより、輝度の高いディスプレイパネルが得られる。

【 0 0 6 2 】

また副画素領域を規定する第 2 のバンクは正孔輸送層または中間層上に配置されるので、第 2 のバンクと正孔輸送層または中間層とを互いに密着させることが好ましい。したがって、第 2 のバンクの表面の濡れ性を、第 1 のバンクの表面の濡れ性よりも高くして、正孔輸送層または中間層との密着性を高めてもよい。例えば、第 2 のバンクの水に対する接触角は 40 ° 以下である。そのため、第 2 のバンクの材質は、非フッ素系樹脂（非フッ素系ポリイミド樹脂や非フッ素系ポリアクリル樹脂など）でありうる。

【 0 0 6 3 】

このように第 2 のバンクは、正孔輸送層または中間層の上に形成される。したがって正孔輸送層または正孔輸送層および中間層を、いわゆる「ベタ塗り」によって作製することができる。つまり、正孔輸送層や中間層をスピンコート法、ダイコート法、スリットコート法などによって容易に形成でき、しかもその厚さを一定にすることができる。

【 0 0 6 4 】

第 2 のバンクの深さは、1 ~ 2 μ m 程度であればよい。また、第 2 のバンクの頂点の基板からの高さよりも、第 1 のバンクの頂点は、約 1 ~ 10 μ m 高いことが好ましい。後述

するように、第1のバンクで規定される画素領域に、高分子有機EL材料と溶液を含むインクを塗布することにより有機EL層を形成するので、画素領域を規定する障壁を高くして隣接する画素領域にインクが浸入することを防止するためである。

【0065】

副画素領域を規定する第2のバンクには、隣接する副画素領域同士を連通する溝が設けられていてもよい(図3参照)。第2のバンクを形成後、第2のバンクによって規定された副画素領域には、中間層の材料を含む溶液または高分子有機EL材料を含むインクが画素領域に塗布されうる。したがって、副画素領域同士を連通する溝が設けられていると、副画素領域の間を溶液またはインクが移動でき、形成される中間層または有機EL層の厚さが画素領域内において平準化される。溝の深さは第2のバンクの深さの9割以内であればよく、溝の幅は約20~50μmであればよい。また、隣接する副画素領域同士の間隔は、通常は10μm以上である。副画素領域の横幅(第1のバンクのラインの方向を縦とする)は、約60~100μmである。

10

【0066】

2. 本発明の有機ELディスプレイパネルの製造方法について

本発明の有機ELディスプレイパネルは、本発明の効果を損なわない限り、任意の方法で製造されうる。

好ましい製造方法の第1の例は、1)基板に第一の導電層を面形成するステップ、2)前記第一の導電層が形成された基板面に、正孔輸送層を形成するステップ、3)前記正孔輸送層上に、ライン状の電気絶縁性の障壁を形成して、ライン状の画素領域となる領域を規定するステップ、4)前記画素領域となる領域内に、ライン状の有機EL層を形成するステップ、および5)前記有機EL層に第二の導電層を形成するステップを含む。

20

【0067】

1)ステップにおいて、第一の導電層は、基板に導電体薄膜を成膜して、フォトリソグラフィ加工またはエッチング加工によりライン状(図3参照)またはマトリクス状(図1B参照)にパターンニングするなどして形成すればよいが、特にその手法は限定されない。第1の導電層はアノード電極となる。

【0068】

2)ステップにおいて、正孔輸送層の材質がPEDOT-PPSである場合、第1の導電層が形成された基板面に正孔輸送層を面形成するには、スピンコート、ダイコート、またはスリットコート法などを採用することが好ましい。簡便な方法でありながら、比較的均一な厚さの層を形成することができる。一方、正孔輸送層の材質がタングステンオキサイドなどの酸化物である場合、正孔輸送層は例えばスパッタ法や加熱蒸着法によって形成される。

30

【0069】

3)ステップでは正孔輸送層上に画素領域を規定するライン状の電気絶縁性の障壁を形成する。第1の導電層がライン状に形成されている場合(図3参照)、ライン状の障壁のライン方向は、ライン状の導電層のライン方向に直交することが好ましい。当該障壁は、正孔輸送層にレジストを塗布し、フォトマスクでライン状に感光させて形成してもよく、凹版印刷により絶縁性樹脂成型物を印刷してもよい。前者の方法では、照射する光によって正孔輸送層や中間層に損傷を与えることがあるので、好ましくは後者の方法を採用する。当該ライン状の障壁により、画素領域となる領域が規定される。また、当該障壁はカソード電極セパレータとなりうる。

40

【0070】

画素領域に、さらに第2の電気絶縁性の障壁を形成してもよい。当該障壁も、正孔輸送層上にレジストを塗布し、フォトマスクでライン状に感光させて形成してもよく、凹版印刷により絶縁性樹脂を印刷してもよい。当該障壁により、副画素となる複数の領域が規定される。また当該障壁は、副画素となる領域を規定するが、隣接する領域同士を連通する溝を有していてもよい。溝はエッチングなどで形成してもよい。また、凹版印刷により予め溝が形成された樹脂成型物を印刷してもよい。

50

【 0 0 7 1 】

ライン状の電気絶縁性の障壁の形成と、副画素となる領域を規定する領域の形成とは、いずれを先に行なってもよく、同時に行なってもよい。例えば、凹版印刷により絶縁性樹脂を印刷する場合には、所望の形状の樹脂成型物を印刷することによって、両方の障壁を同時に形成することができる。

【 0 0 7 2 】

本製造方法の例は、３）ステップの前または後に中間層を形成するステップを有していてもよい。つまり、３）ステップの前に中間層を形成する場合、中間層は正孔輸送層上に面形成することが好ましい。一方、３）ステップの後に中間層を形成する場合、中間層をライン状の電気絶縁性の障壁の形成後に障壁によって規定された画素領域内に形成（ライン形成）することが好ましい。

10

中間層を形成するにはスピンコート、ダイコート、またはスリットコート法などを採用することが好ましい。

【 0 0 7 3 】

また本製造方法の例は、３）ステップの前であって中間層の形成前、または３）ステップの前であって中間層の形成後に、無機絶縁膜を形成するステップを有していてもよい。

つまり、中間層が面形成される場合、無機絶縁膜は、中間層上であって、電気絶縁性の障壁の下に形成される。一方、中間層がライン形成される場合、無機絶縁膜は、正孔輸送層上であって、電気絶縁性の障壁の下に形成される。

無機絶縁膜は例えば、プラズマＣＶＤ法やスパッタ法によって形成される。

20

【 0 0 7 4 】

正孔輸送層は、基板面全体に形成してもよいが、少なくとも全ての画素領域を含む領域に形成すればよい。

通常は、正孔輸送層および中間層のいずれもが形成されるが、正孔輸送層は形成されないこともありうる。

【 0 0 7 5 】

４）ステップにおいて規定された画素領域内に、高分子有機ＥＬ材料と溶媒を含むインクをコートする。コートは、インクジェット、ディスペンサー、ノズルコート、凹版印刷または凸版印刷などの手法を用いて行なえばよい。ディスペンサーにより塗布する場合は、塗布するラインの始端と終端でサックバック動作などにより、ディスペンサーからのインクの吐出を制御することが好ましい。塗布されたインクの厚み（コート膜の厚み）は、約１～１０μｍとすればよい。さらにコート膜を乾燥させることによって高分子有機ＥＬ材料を含む層が形成され、好ましくは画素領域内の副画素領域に選択的に形成される。

30

【 0 0 7 6 】

さらに高分子有機ＥＬ材料を含む層をスキージしてもよい。具体的にスキージは、コーターなどを用いて行なえばよい。スキージにより、高分子を構成する構造単位の配向性を高めることができ、発光効率を向上させることができる。

【 0 0 7 7 】

５）ステップにおいて、有機ＥＬ層上に第二の導電層を形成する。第２の導電層は蒸着法により作製されればよい。ライン状の電気絶縁性の障壁を逆テーパ形状にすれば、より確実に第二の導電層を画素毎に切断することができる。

40

【 0 0 7 8 】

好ましい製造方法の第２の例は、１）基板面に第一の導電層を形成するステップ、２）前記第一の導電層が形成された基板面に、ライン状の電気絶縁性の障壁を形成して、ライン状の画素領域となる領域を規定するステップ、３）前記画素領域となる領域内に、ライン状の正孔輸送層を形成するステップ、４）前記画素領域となる領域内に、ライン状の中間層を形成するステップ、５）前記画素領域となる領域に、ライン状の高分子有機ＥＬ層を形成するステップ、および６）前記有機ＥＬ層に第二の導電層を形成するステップを含む。

【 0 0 7 9 】

50

また上記製造方法は、１）ステップと２）ステップとの間に、基板上に絶縁性の無機膜（以下、「無機絶縁膜」という）を形成するステップを有していてもよい。この場合、画素領域を規定する電気絶縁性の障壁は、無機絶縁膜上に形成されることが好ましい。

【００８０】

また、正孔輸送層の材質がタングステンオキサイドなどの酸化物である場合、２）ステップと３）ステップとは順序が逆であってもよい。

【００８１】

製造方法の第２の例における、基板面に第一の導電層を形成するステップ、ライン状の高分子有機ＥＬ層を形成するステップ、および第二の導電層を形成するステップは、第１の例と同様のステップであり、同様の手段で行なえばよい。

10

【００８２】

２）ステップにおいて、第１の導電層が形成された基板面に、ライン状の電気絶縁性の障壁を形成する。第１の導電層がライン状に形成されている場合、ライン状の障壁のライン方向は、ライン状の導電層のライン方向と直交することが好ましい。当該障壁は、基板面にレジストを塗布し、フォトリソでライン状に感光させて形成してもよく、凹版印刷により絶縁性樹脂成型物を印刷してもよい。当該障壁により画素領域が規定される。また当該障壁は、カソードセパレータとなりうる。

【００８３】

３）ステップにおいてライン状の電気絶縁性の障壁により規定された画素領域に、正孔輸送層を形成し、４）ステップにおいてライン状の電気絶縁性の障壁により規定された画素領域内であって正孔輸送層上に中間層を形成する。正孔輸送層または中間層は、スピコート、ダイコートまたはスリットコートなどの手段で形成することができる。

20

【００８４】

画素領域内に配置された正孔輸送層上に、第２の電気絶縁性の障壁を形成して、副画素領域を規定してもよい。副画素領域を規定する障壁は、正孔輸送層にレジストを塗布し、フォトリソでライン状に感光させて形成してもよく、凹版印刷により絶縁性樹脂成型物を印刷してもよい。

副画素領域を規定した後、第１の例の製造方法と同様にして、画素領域に高分子有機ＥＬ材料と溶媒を含むインクをコートして、有機ＥＬ層を形成する。

【００８５】

30

以下において、図面を参照して本発明の実施形態をより詳細に説明する。

【００８６】

〔実施の形態１〕

実施の形態１では正孔輸送層が面形成されるアクティブマトリクス型有機ＥＬディスプレイパネルについて説明する。

【００８７】

図１Ａはアクティブマトリクス型の有機ＥＬディスプレイパネルの平面図である。図１Ａに示されたパネルには、ライン状に形成された副数本の第１のバンク９が配置されている。第１のバンク９は画素領域１７を規定している。画素領域１７は、レッドの光を発光する画素領域１７Ｒ；グリーン光を発光する画素領域１７Ｇ；ブルーの光を発光する画素領域１７Ｂに分類され、順番に配置されている。画素領域１７は、カソード電極１５で覆われており、第１のバンク９によって画素領域毎に分離されている。

40

【００８８】

図１Ｂはカソード電極を除去した本実施の形態のアクティブマトリクス型の有機ＥＬディスプレイパネルの平面図である。

【００８９】

図２Ａには、図１Ｂに示された本実施の形態の有機ＥＬディスプレイパネルの線Ａ－Ａの断面図が示される。図２Ｂには、図１Ｂに示された本実施の形態の有機ＥＬディスプレイパネルの線Ｂ－Ｂの断面図が示される。

【００９０】

50

図 2 A および図 2 B に示されるように、本実施の形態では、基板 1 上にマトリクス状のアノード電極 3 が配置される。正孔輸送層 5 はアノード電極 3 を覆うように基板 1 上に面形成される。第 1 のバンク 9 は正孔輸送層 5 上に無機絶縁膜 2 2 を介して配置され画素領域 1 7 を規定する。第 1 のバンク 9 は、濡れ性を下げるためフッ素樹脂などで形成されることが好ましい。中間層 7 は画素領域 1 7 内の正孔輸送層 5 上に配置される。中間層 7 上の画素領域 1 7 には高分子有機 E L 層 1 3 が配置される。

【 0 0 9 1 】

[実施の形態 2]

実施の形態 1 ではアクティブマトリクス型有機 E L ディスプレイパネルについて説明した。実施の形態 2 ではパッシブマトリクス型有機 E L ディスプレイパネルについて説明する。また本実施の形態では有機 E L ディスプレイパネルは第 2 のバンクを有する。

10

【 0 0 9 2 】

図 3 は、本実施の形態の有機 E L ディスプレイからカソード電極 1 5 を除去した状態の平面図である。図 3 に示されたパネルは、基板 1 と、ライン状に形成された複数本のアノード電極 3 ' と、ライン状に形成された副数本の第 1 のバンク 9 が配置されている。アノード電極 3 ' のラインの方向（図面横方向）と、第 1 のバンク 9 のラインの方向（図面縦方向）とは、直角に交差している。

【 0 0 9 3 】

画素領域 1 7 の内部には、第 2 のバンク 1 1 で規定された 2 以上の副画素領域 1 9 が配置されている。同一の画素領域 1 7 において互いに隣接する副画素領域 1 9 は、溝 2 1 によって連通している。副画素領域 1 9 および溝 2 1 には、各色に対応する高分子有機 E L 材料 1 3 が配置されている。

20

【 0 0 9 4 】

図 4 A には、図 3 に示された本実施の形態の有機 E L ディスプレイパネルの線 A - A の断面図が示される。図 4 B には、図 3 に示された本実施の形態の有機 E L ディスプレイパネルの線 B - B の断面図が示される。

【 0 0 9 5 】

図 4 A および図 4 B に示されるように、本実施の形態の有機 E L ディスプレイパネルは、アノード電極 3 ' および第 2 のバンク 1 1 を有することならびに無機絶縁膜 2 2 を有しないこと以外は実施の形態 1 の有機 E L ディスプレイパネルと同じである。したがって、実施の形態 1 の有機 E L ディスプレイパネルと同一の部材については同一の符号を付して説明を省略する。

30

【 0 0 9 6 】

図 4 A および図 4 B に示されるように、基板 1 上にライン状のアノード電極 3 ' が配置される。正孔輸送層 5 は、アノード電極 3 ' を覆うように基板 1 上に面形成される。

中間層 7 上には第 2 のバンク 1 1 が配置され副画素領域 1 9 を規定する。第 1 のバンク 9 の頂点は、第 2 のバンク 1 1 の頂点よりも、基板 1 から高い。その高さの差は、例えば 1 μ m 以上 10 μ m 以下である。また、第 2 のバンク 1 1 は、中間層 7 との密着性を考慮して、ある程度の濡れ性を有することが好ましい。

【 0 0 9 7 】

高分子有機 E L 材料 1 3 は、副画素領域 1 9 内にパターンニングされているか、または画素領域 1 7 にパターンニングされている。

40

【 0 0 9 8 】

図 4 B に示されるように、第 2 のバンク 1 1 の（図中左右の）両端よりも、内部の第 2 のバンク 1 1 は低くされている。内部の第 2 のバンク 1 1 は溝 2 1（図 3 参照）に対応している。内部の第 2 のバンク 1 1（溝 2 1）を覆うようにして、高分子有機 E L 層 1 3 が配置されている。つまり、溝 2 1 は、隣接する副画素領域 1 9 同士を連通させている。第 1 のバンク 9 で規定された画素領域 1 7 に、高分子有機 E L 材料を含むポリマーインクを塗布した場合に、副画素領域 1 9 が互いに連通することなく独立していると、各副画素領域 1 9 に形成される高分子有機 E L 層 1 3 の厚さが一定となりにくい。一方、溝 2 1 を設

50

けておくと、画素領域 17 に塗布されたポリマーインクが、副画素領域 19 同士を移動できるので、高分子有機 EL 層 13 の厚さが平準化される。

【0099】

[実施の形態 3]

実施の形態 1 および 2 では正孔輸送層が面形成され、中間層がライン形成された有機 EL ディスプレイパネルについて説明した。実施の形態 3 では、中間層が面形成される有機 EL ディスプレイパネルについて説明する。また本実施の形態の有機 EL ディスプレイパネルは、パッシブマトリクス型であり、第 2 のバンクを有する。

【0100】

本実施の形態の有機 EL ディスプレイパネルの平面図は実施の形態 2 と同じである。したがって図 3 は本実施の有機 EL ディスプレイパネルの平面図でもある。

10

【0101】

図 5 A には、図 3 に示された本実施の形態の有機 EL ディスプレイパネルの線 A - A の断面図が示される。図 5 B には、図 3 に示された本実施の形態の有機 EL ディスプレイパネルの線 B - B の断面図が示される。

【0102】

図 5 A および図 5 B に示されるように、本実施の形態の有機 EL ディスプレイパネルは、中間層 5 の形状および第 1 のバンク 9 の配置位置以外は実施の形態 2 の有機 EL ディスプレイパネルと同じである。したがって、実施の形態 2 の有機 EL ディスプレイパネルと同一の部材については同一の符号を付して説明を省略する。

20

【0103】

図 5 A および図 5 B に示されるように、中間層 7 は面形成された正孔輸送層 5 の上に面形成される。面形成された中間層 7 上には第 1 のバンク 9、第 2 のバンク 11 および高分子有機 EL 層 13 が配置される。

【0104】

[実施の形態 4]

実施の形態 1 ~ 3 では、正孔輸送層が面形成される有機 EL ディスプレイパネルについて説明した。実施の形態 4 では、正孔輸送層がライン形成される有機 EL ディスプレイパネルについて説明する。また、本実施の形態の有機 EL ディスプレイパネルはアクティブマトリクス型である。

30

【0105】

本実施の形態の有機 EL ディスプレイパネルの平面図は実施の形態 1 と同じである。したがって図 1 A および図 1 B は本実施の有機 EL ディスプレイパネルの平面図でもある。

【0106】

図 6 A には、図 1 B に示された本実施の形態の有機 EL ディスプレイパネルの線 A - A の断面図が示される。図 6 B には、図 1 B に示された本実施の形態の有機 EL ディスプレイパネルの線 B - B の断面図が示される。

【0107】

図 6 A および図 6 B に示されるように本実施の形態の有機 EL ディスプレイパネルは、正孔輸送層 5 の形状、第 1 のバンク 9 および無機絶縁膜 22 の配置位置以外は、実施の形態 1 の有機 EL ディスプレイパネルと同じである。したがって、実施の形態 1 の有機 EL ディスプレイパネルと同一の構成要素については同一の符号を付して説明を省略する。

40

【0108】

図 6 A で示されるように、正孔輸送層 5 は第 1 のバンク 9 によって規定された画素領域 17 内にライン形成される。また絶縁膜 22 は正孔輸送層 5 の下であって基板 1 上に配置される。第 1 のバンク 9 は、絶縁膜 22 上に配置される。

【0109】

[実施の形態 5]

実施の形態 4 では、第 2 のバンクを有しない有機 EL ディスプレイパネルについて説明した。実施の形態 5 では、正孔輸送層がライン形成され、第 2 のバンクを有する有機 EL

50

ディスプレイパネルを説明する。また、本実施の形態の有機 E L ディスプレイパネルはパッシブマトリクス型である。

【 0 1 1 0 】

本実施の形態の有機 E L ディスプレイパネルの平面図は実施の形態 2 と同じである。したがって図 3 は本実施の有機 E L ディスプレイパネルの平面図でもある。

【 0 1 1 1 】

図 7 A には、図 3 に示された本実施の形態の有機 E L ディスプレイパネルの線 A - A の断面図が示される。図 7 B には、図 3 に示された本実施の形態の有機 E L ディスプレイパネルの線 B - B の断面図が示される。

【 0 1 1 2 】

図 7 A および図 7 B に示されるように、本実施の形態の有機 E L ディスプレイパネルは、アノード電極 3 ' および第 2 のバンク 1 1 を有することならびに絶縁膜 2 2 を有しないこと以外は実施の形態 4 の有機 E L ディスプレイパネルと同じである。したがって、実施の形態 1 の有機 E L ディスプレイパネルと同一の部材については同一の符号を付して説明を省略する。

【 0 1 1 3 】

図 7 A および図 7 B に示されるように、基板 1 上にライン状のアノード電極 3 ' が配置される。正孔輸送層 5 は、画素領域 1 7 内のアノード電極 3 ' 上に形成（ライン形成）される。中間層 7 上には第 2 のバンク 1 1 が配置され副画素領域を規定する。第 1 のバンク 9 の頂点は、第 2 のバンク 1 1 の頂点よりも、基板 1 から高い。その高さの差は、例えば 1 μ m 以上 10 μ m 以下である。また、第 2 のバンク 1 1 は、中間層 7 との密着性を考慮して、ある程度の濡れ性を有することが好ましい。

【 0 1 1 4 】

高分子有機 E L 材料 1 3 は、副画素領域 1 9 内にパターンニングされているか、または画素領域 1 7 にパターンニングされている。

【 0 1 1 5 】

図 7 B に示されるように、第 2 のバンク 1 1 の（図中左右の）両端よりも、内部の第 2 のバンク 1 1 は低くされている。内部の第 2 のバンク 1 1 は溝 2 1（図 3 参照）に対応している。内部の第 2 のバンク 1 1（溝 2 1）を覆うようにして、高分子有機 E L 材料 1 3 の層が配置されている。つまり、溝 2 1 は、隣接する副画素領域 1 9 同士を連通させている。第 1 のバンク 9 で規定された画素領域 1 7 に、高分子有機 E L 材料を含むポリマーインクを塗布した場合に、副画素領域 1 9 が互いに連通することなく独立していると、各副画素領域 1 9 に形成される高分子有機 E L 層 1 3 の厚さが一定となりにくい。一方、溝 2 1 を設けておくと、画素領域 1 7 に塗布されたポリマーインクが、副画素領域 1 9 同士を移動できるので、高分子有機 E L 層 1 3 の厚さが平準化される。

【 0 1 1 6 】

[実施の形態 6]

図 8 には、実施の形態 5 と同様に、正孔輸送層 5 および中間層 7 のいずれもが各画素領域 1 7 上にライン形成されている。本形態は、画素領域 1 7 を規定する第 1 のバンク 9 が逆テーパ形状に成形されていることを特徴とする。逆テーパ形状とすることにより、第 1 のバンク 9 がカソードセパレータとしてより有効に作用し、蒸着法により有機 E L 層 1 3 のそれぞれに形成されたカソード電極が互いに通電することを、より確実に防止することができる。

【 0 1 1 7 】

本出願は、2007年5月30日出願の特願2007-143906に基づく優先権を主張する。当該出願明細書に記載された内容は、すべて本願明細書に援用される。

【産業上の利用可能性】

【 0 1 1 8 】

本発明の有機 E L ディスプレイパネルは、それに含まれる高分子有機 E L 層をインクジェット法などにより形成することができ、かつ正孔輸送層などをスピコート法などによ

10

20

30

40

50

り形成することができるので、その製造プロセスが簡便である。さらに、高分子有機 E L 層の厚さが一定となるので発光特性も向上する。よって、従来よりも高性能なディスプレイパネルが効率よく製造される。

【図面の簡単な説明】

【 0 1 1 9 】

【図 1 A】本発明の有機 E L ディスプレイパネルの平面図である。

【図 1 B】カソード電極を除去した状態の有機 E L ディスプレイパネルの平面図である。

【図 2 A】実施の形態 1 における、図 1 に示された有機 E L ディスプレイパネルの A - A の断面図である。

【図 2 B】実施の形態 1 における、図 1 に示された有機 E L ディスプレイパネルの B - B の断面図である。

10

【図 3】カソード電極を除去した状態の有機 E L ディスプレイパネルの平面図である。

【図 4 A】実施の形態 2 における、図 3 に示された有機 E L ディスプレイパネルの A - A の断面図である。

【図 4 B】実施の形態 2 における、図 3 に示された有機 E L ディスプレイパネルの B - B の断面図である。

【図 5 A】実施の形態 3 における、図 3 に示された有機 E L ディスプレイパネルの A - A の断面図である。

【図 5 B】実施の形態 3 における、図 3 に示された有機 E L ディスプレイパネルの B - B の断面図である。

20

【図 6 A】実施の形態 4 における、図 1 に示された有機 E L ディスプレイパネルの A - A の断面図である。

【図 6 B】実施の形態 4 における、図 1 に示された有機 E L ディスプレイパネルの B - B の断面図である。

【図 7 A】実施の形態 5 における、図 3 に示された有機 E L ディスプレイパネルの A - A の断面図である。

【図 7 B】実施の形態 5 における、図 3 に示された有機 E L ディスプレイパネルの B - B の断面図である。

【図 8】逆テーパ形状の第 1 のバンクを有する有機 E L ディスプレイの断面図である。

【図 9】中間層の下に絶縁膜を有する有機 E L ディスプレイパネルの断面図である。

30

【図 10】中間層の下に絶縁膜を有する有機 E L ディスプレイパネルの断面図である。

【図 11】正孔輸送層の下に絶縁膜を有する有機 E L ディスプレイパネルの断面図である。

【符号の説明】

【 0 1 2 0 】

1 基板

3、3' アノード電極

5 正孔輸送層

7 中間層

9 第 1 のバンク

11 第 2 のバンク

13 高分子有機 E L 層

15 カソード電極

17 画素領域

19 副画素領域

21 溝

22 無機絶縁膜

23 コンタクトホール

40

【手続補正 3】

【補正対象書類名】図面

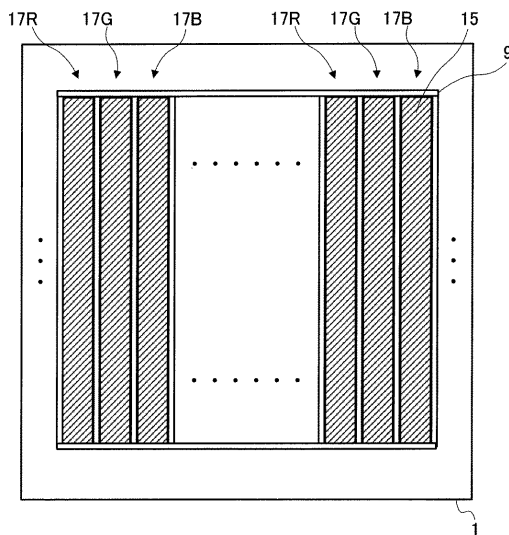
50

【補正対象項目名】全図

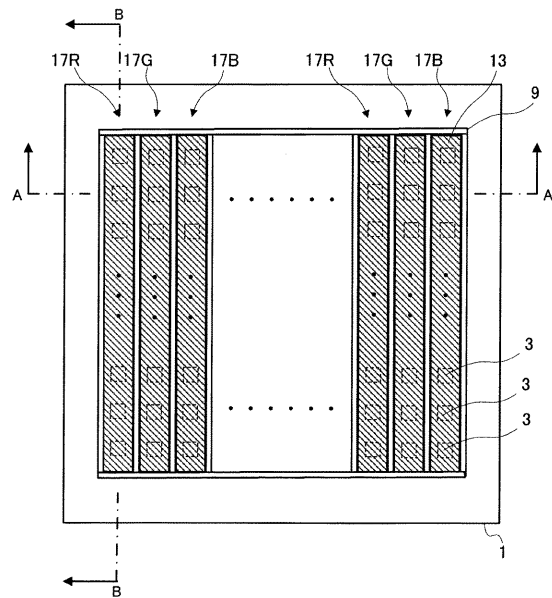
【補正方法】変更

【補正の内容】

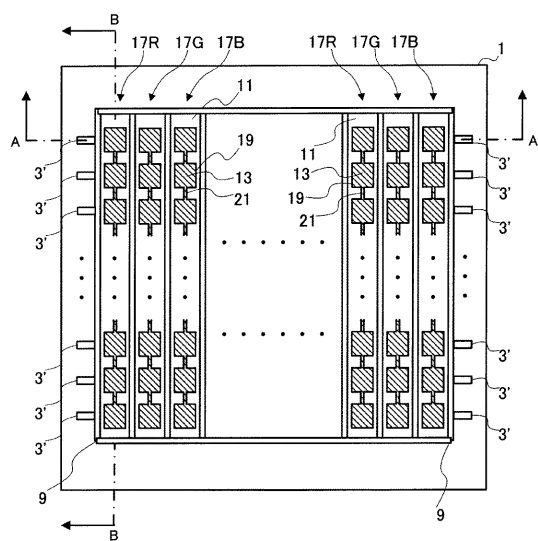
【図 1 A】



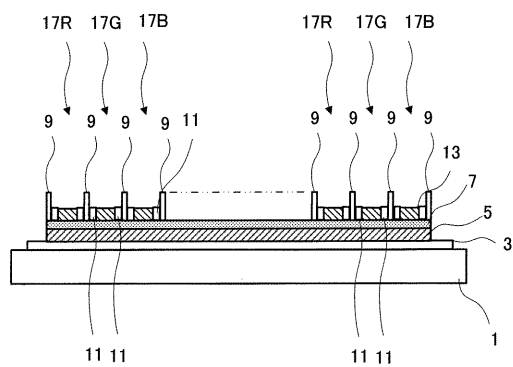
【図 1 B】



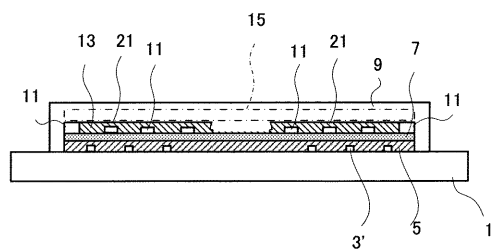
【图 3】



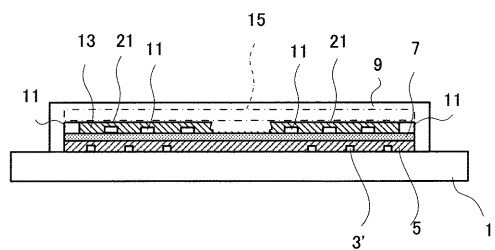
【 図 5 A 】



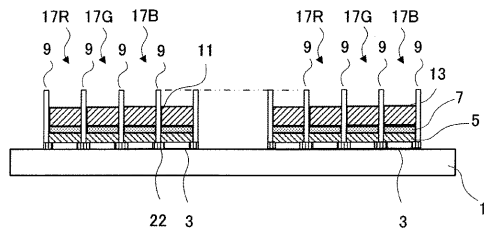
【 図 5 B 】



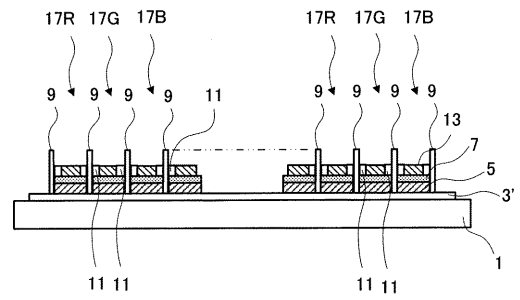
【 図 5 B 】



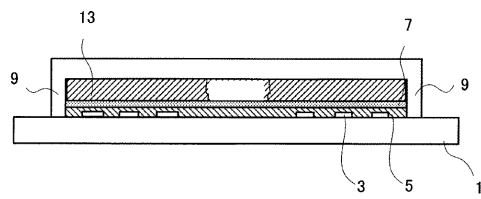
【図 6 A】



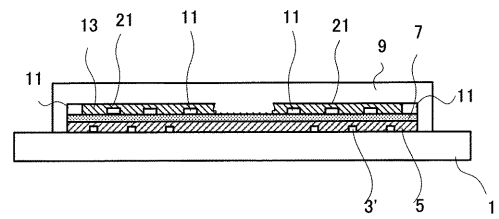
【図 7 A】



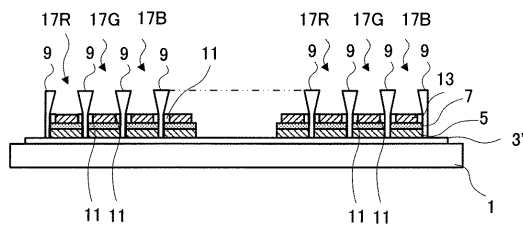
【図 6 B】



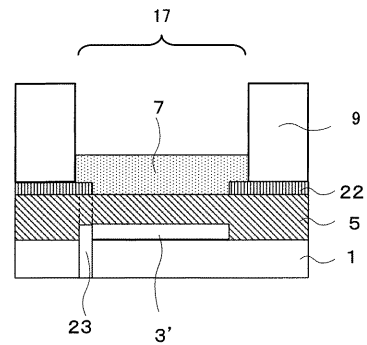
【図 7 B】



【図 8】



【図 9】



【図 10】

図10A

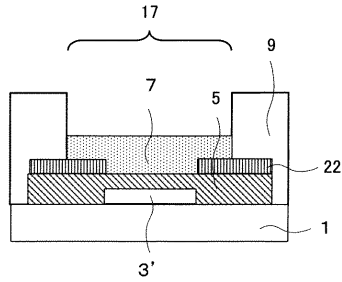


図10B

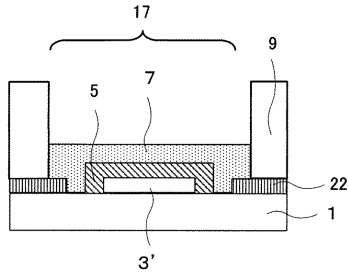
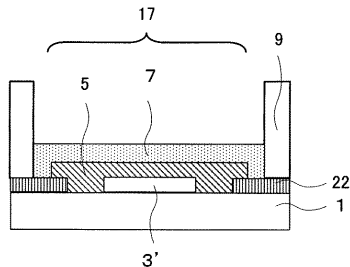
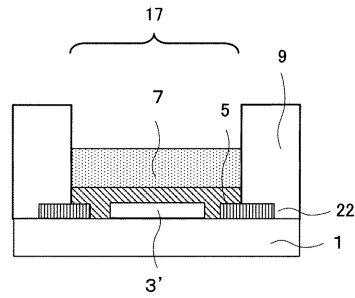


図10C



【図 11】



【手続補正書】

【提出日】平成21年4月6日(2009.4.6)

【手続補正 1】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】全文

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項 1】

基板上に配置されたアノード電極；

前記アノード電極が配置された基板面に設けられた正孔輸送層；

前記正孔輸送層上に設けられ、ライン状の画素領域を規定するライン状のバンク；

前記正孔輸送層上に配置された、前記画素領域の内部に 2 以上の副画素領域を規定する第 2 のバンク；

前記画素領域内に配置されたライン状の電子ブロック層；

前記画素領域内であって、前記電子ブロック層上に配置されたライン状の高分子有機 EL 層；および

前記高分子有機 EL 層上に設けられたカソード電極；を含む有機 EL ディスプレイパネルであって、

前記第 2 のバンクは、隣接する副画素領域同士を連通する溝を有する、有機 EL ディスプレイパネル。

【請求項 2】

前記バンクは、フッ素樹脂を含むか、または前記バンクの表面がフッ素系ガスプラズマによりフッ素化されている、請求項 1 に記載の有機 EL ディスプレイパネル。

【請求項 3】

前記正孔輸送層の材質は、タングステンオキサイド (WO_x)、モリブデンオキサイド (MoO_x)、バナジウムオキサイド (VO_x)、またはこれらの組み合わせを含み、

前記ライン状のバンクから前記画素領域内にはみ出し、前記ライン状の電子ブロック層またはライン状の高分子有機EL層の底面に接する絶縁性の無機膜をさらに有する、請求項1に記載の有機ELディスプレイパネル。

【請求項4】

前記アノード電極は基板上にマトリクス状に配置されているアクティブマトリクス型の請求項1に記載の有機ELディスプレイパネル。

【請求項5】

前記高分子有機EL層は、前記画素領域に、高分子有機EL材料と溶媒とを含むインクをインクジェット、ディスペンサー、ノズルコート、凹版印刷または凸版印刷によりコートして形成される、請求項1に記載の有機ELディスプレイパネル。

【請求項6】

前記電子ブロック層は、電子ブロック層の材料を含む溶液をスピンコート、ダイコート、またはスリットコートによりコートして形成される、請求項1に記載の有機ELディスプレイパネル。

【請求項7】

基板上に配置されたアノード電極；

基板上に設けられ、ライン状の画素領域を規定するライン状のバンク；

前記画素領域内に配置されたライン状の正孔輸送層；

前記正孔輸送層上に配置された、前記画素領域の内部に2以上の副画素領域を規定する第2のバンク；

前記画素領域内に配置されたライン状の電子ブロック層；

前記画素領域内であって、前記電子ブロック層上に配置されたライン状の高分子有機EL層；および

前記高分子有機EL層上に設けられたカソード電極；を含む有機ELディスプレイパネルであって、

前記第2のバンクは、隣接する副画素領域同士を連通する溝を有する、有機ELディスプレイパネル。

【請求項8】

前記バンクは、フッ素樹脂を含むか、または前記バンクの表面がフッ素系ガスプラズマによりフッ素化されている、請求項7に記載の有機ELディスプレイパネル。

【請求項9】

前記ライン状の正孔輸送層の材質は、タングステンオキサイド (WO_x)、モリブデンオキサイド (MoO_x)、バナジウムオキサイド (VO_x)、またはこれらの組み合わせを含み、

前記ライン状のバンクから前記画素領域内にはみ出し、前記ライン状の電子ブロック層またはライン状の高分子有機EL層の底面に接する絶縁性の無機膜をさらに有する、

請求項7に記載の有機ELディスプレイパネル。

【請求項10】

前記ライン状の正孔輸送層の材質は、ポリエチレンジオキシチオフェンを含み、

前記ライン状のバンクから前記画素領域内にはみ出し、前記ライン状の正孔輸送層の底面に接する絶縁性の無機膜をさらに有する、

請求項7に記載の有機ELディスプレイパネル。

【請求項11】

前記アノードは基板上にマトリクス状に配置されているアクティブマトリクス型の請求項7に記載の有機ELディスプレイパネル。

【請求項12】

前記高分子有機EL層は、前記画素領域に、高分子有機EL材料と溶媒とを含むインクをインクジェット、ディスペンサー、ノズルコート、凹版印刷または凸版印刷によりコー

10

20

30

40

50

トして形成される、請求項 7 に記載の有機 E L ディスプレイパネル。

【請求項 1 3】

前記電子ブロック層は、電子ブロック層の材料を含む溶液をスピンコート、ダイコート、またはスリットコートによりコートして形成される、請求項 9 に記載の有機 E L ディスプレイパネル。

【請求項 1 4】

前記正孔輸送層は、正孔輸送層の材料を含む溶液をスピンコート、ダイコート、またはスリットコートによりコートして形成される、請求項 1 0 に記載の有機 E L ディスプレイパネル。

【 国際調査報告 】

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.

PCT/JP2008/001268

A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER H05B33/22(2006.01)i, H01L51/50(2006.01)i, H05B33/10(2006.01)i, H05B33/12(2006.01)i According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC		
B. FIELDS SEARCHED Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols) H05B33/22, H01L51/50, H05B33/10, H05B33/12 Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched Jitsuyo Shinan Koho 1922-1996 Jitsuyo Shinan Toroku Koho 1996-2008 Kokai Jitsuyo Shinan Koho 1971-2008 Toroku Jitsuyo Shinan Koho 1994-2008 Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practicable, search terms used)		
C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT		
Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
Y	JP 2004-235128 A (Dainippon Printing Co., Ltd.), 19 August, 2004 (19.08.04), Particularly, Par. Nos. [0011], [0031] to [0033], [0048], [0052], [0058], [0060]; Fig. 1 (Family: none)	1-3, 5-11, 13-18
Y	JP 2004-234901 A (Seiko Epson Corp.), 19 August, 2004 (19.08.04), Particularly, Par. Nos. [0013] to [0022], [0041], [0045]; Fig. 1 (Family: none)	1-3, 5-11, 13-18
☒ Further documents are listed in the continuation of Box C. ☐ See patent family annex.		
* Special categories of cited documents: "A" document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance "E" earlier application or patent but published on or after the international filing date "L" document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified) "O" document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means "P" document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed "T" later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention "X" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone "Y" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art "&" document member of the same patent family		
Date of the actual completion of the international search 13 August, 2008 (13.08.08)		Date of mailing of the international search report 02 September, 2008 (02.09.08)
Name and mailing address of the ISA/ Japanese Patent Office		Authorized officer
Facsimile No.		Telephone No.

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.

PCT/JP2008/001268

C (Continuation). DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
Y	JP 2005-235569 A (Seiko Epson Corp.), 02 September, 2005 (02.09.05), Particularly, Par. Nos. [0024] to [0061], [0076] to [0086]; Figs. 1, 3 (Family: none)	1-3, 5-11, 13-18
Y	JP 2007-19489 A (Semiconductor Energy Laboratory Co., Ltd.), 25 January, 2007 (25.01.07), Particularly, Par. Nos. [0008], [0018] & US 2006/0284189 A1	1-3, 5-11, 13-18
Y	JP 2006-114477 A (Semiconductor Energy Laboratory Co., Ltd.), 27 April, 2006 (27.04.06), Particularly, Claims 1 to 5 & JP 2006-114521 A & US 2007/0200125 A1 & EP 1776846 A & WO 2005/031798 A2 & KR 10-2006-0099511 A & CN 1860829 A	1-3, 5-11, 13-18
Y	JP 2007-26976 A (Toppan Printing Co., Ltd.), 01 February, 2007 (01.02.07), Particularly, Par. Nos. [0001], [0036], [0043], [0046] to [0053]; Fig. 4 (Family: none)	1-3, 5-11, 13-18
A	JP 2000-195668 A (Toyota Motor Corp.), 14 July, 2000 (14.07.00), Particularly, Fig. 7 (Family: none)	4, 12
A	JP 2007-95614 A (Seiko Epson Corp.), 12 April, 2007 (12.04.07), Particularly, Fig. 9 & US 2007/0075618 A1 & KR 10-2007-0037344 A & CN 1941403 A	4, 12

国際調査報告		国際出願番号 PCT/J P 2 0 0 8 / 0 0 1 2 6 8									
A. 発明の属する分野の分類 (国際特許分類 (IPC)) Int.Cl. H05B33/22 (2006.01)i, H01L51/50 (2006.01)i, H05B33/10 (2006.01)i, H05B33/12 (2006.01)i											
B. 調査を行った分野 調査を行った最小限資料 (国際特許分類 (IPC)) Int.Cl. H05B33/22, H01L51/50, H05B33/10, H05B33/12											
最小限資料以外の資料で調査を行った分野に含まれるもの <table border="0"> <tr> <td>日本国実用新案公報</td> <td>1922-1996年</td> </tr> <tr> <td>日本国公開実用新案公報</td> <td>1971-2008年</td> </tr> <tr> <td>日本国実用新案登録公報</td> <td>1996-2008年</td> </tr> <tr> <td>日本国登録実用新案公報</td> <td>1994-2008年</td> </tr> </table>				日本国実用新案公報	1922-1996年	日本国公開実用新案公報	1971-2008年	日本国実用新案登録公報	1996-2008年	日本国登録実用新案公報	1994-2008年
日本国実用新案公報	1922-1996年										
日本国公開実用新案公報	1971-2008年										
日本国実用新案登録公報	1996-2008年										
日本国登録実用新案公報	1994-2008年										
国際調査で使用した電子データベース (データベースの名称、調査に使用した用語)											
C. 関連すると認められる文献											
引用文献の カテゴリー*	引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示	関連する 請求の範囲の番号									
Y	JP 2004-235128 A (大日本印刷株式会社) 2004.08.19, 特に、段落【0011】、【0031】-【0033】、【0048】、【0052】、【0058】、【0060】、 【図1】 (ファミリーなし)	1-3, 5-11, 13-18									
Y	JP 2004-234901 A (セイコーエプソン株式会社) 2004.08.19, 特に、段落【0013】-【0022】、【0041】、【0045】、【図1】 (ファミリーなし)	1-3, 5-11, 13-18									
☒ C欄の続きにも文献が列挙されている。 ☐ パテントファミリーに関する別紙を参照。											
* 引用文献のカテゴリー 「A」 特に関連のある文献ではなく、一般的技術水準を示すもの 「E」 国際出願日前の出願または特許であるが、国際出願日以後に公表されたもの 「L」 優先権主張に疑義を提起する文献又は他の文献の発行日若しくは他の特別な理由を確立するために引用する文献 (理由を付す) 「O」 口頭による開示、使用、展示等に言及する文献 「P」 国際出願日前で、かつ優先権の主張の基礎となる出願 の日の後に公表された文献 「T」 国際出願日又は優先日後に公表された文献であって出願と矛盾するものではなく、発明の原理又は理論の理解のために引用するもの 「X」 特に関連のある文献であって、当該文献のみで発明の新規性又は進歩性がないと考えられるもの 「Y」 特に関連のある文献であって、当該文献と他の1以上の文献との、当業者にとって自明である組合せによって進歩性がないと考えられるもの 「&」 同一パテントファミリー文献											
国際調査を完了した日 13.08.2008		国際調査報告の発送日 02.09.2008									
国際調査機関の名称及びあて先 日本国特許庁 (ISA/J P) 郵便番号100-8915 東京都千代田区霞が関三丁目4番3号		特許庁審査官 (権限のある職員) 濱野 隆 電話番号 03-3581-1101 内線 3271	20 9108								

国際調査報告		国際出願番号 PCT/J P 2 0 0 8 / 0 0 1 2 6 8
C (続き) . 関連すると認められる文献		
引用文献の カテゴリー*	引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示	関連する 請求の範囲の番号
Y	JP 2005-235569 A (セイコーエプソン株式会社) 2005. 09. 02, 特に、段落【0024】 - 【0061】、【0076】 - 【0086】、【図 1】、【図 3】 (ファミリーなし)	1-3, 5-11, 13-18
Y	JP 2007-19489 A (株式会社半導体エネルギー研究所) 2007. 01. 25, 特に、段落【0008】、【0018】 & US 2006/0284189 A1	1-3, 5-11, 13-18
Y	JP 2006-114477 A (株式会社半導体エネルギー研究所) 2006. 04. 27, 特に、【請求項 1】 - 【請求項 5】 & JP 2006-114521 A & US 2007/0200125 A1 & EP 1776846 A & WO 2005/031798 A2 & KR 10-2006-0099511 A & CN 1860829 A	1-3, 5-11, 13-18
Y	JP 2007-26976 A (凸版印刷株式会社) 2007. 02. 01, 特に、段落【0001】、【0036】、【0043】、【0046】 - 【0053】、【図 4】 (ファミリーなし)	1-3, 5-11, 13-18
A	JP 2000-195668 A (トヨタ自動車株式会社) 2000. 07. 14, 特に、【図 7】 (ファミリーなし)	4, 12
A	JP 2007-95614 A (セイコーエプソン株式会社) 2007. 04. 12, 特に、【図 9】 & US 2007/0075618 A1 & KR 10-2007-0037344 A & CN 1941403 A	4, 12

フロントページの続き

(81)指定国 AP(BW,GH,GM,KE,LS,MW,MZ,NA,SD,SL,SZ,TZ,UG,ZM,ZW),EA(AM,AZ,BY,KG,KZ,MD,RU,TJ,TM),
EP(AT,BE,BG,CH,CY,CZ,DE,DK,EE,ES,FI,FR,GB,GR,HR,HU,IE,IS,IT,LT,LU,LV,MC,MT,NL,NO,PL,PT,RO,SE,SI,SK,T
R),OA(BF,BJ,CF,CG,CI,CM,GA,GN,GQ,GW,ML,MR,NE,SN,TD,TG),AE,AG,AL,AM,AO,AT,AU,AZ,BA,BB,BG,BH,BR,BW,BY,
BZ,CA,CH,CN,CO,CR,CU,CZ,DE,DK,DM,DO,DZ,EC,EE,EG,ES,FI,GB,GD,GE,GH,GM,GT,HN,HR,HU,ID,IL,IN,IS,JP,KE,K
G,KM,KN,KP,KR,KZ,LA,LC,LK,LR,LS,LT,LU,LY,MA,MD,ME,MG,MK,MN,MW,MX,MY,MZ,NA,NG,NI,NO,NZ,OM,PG,PH,PL,PT
,RO,RS,RU,SC,SD,SE,SG,SK,SL,SM,SV,SY,TJ,TM,TN,TR,TT,TZ,UA,UG,US,UZ,VC,VN,ZA,ZM,ZW

F ターム(参考) 3K107 AA01 BB01 CC33 CC45 DD60 DD70 DD72 DD89 DD91 DD95
DD96 EE03 EE07 GG06 GG07 GG08 GG24

(注) この公表は、国際事務局(WIPO)により国際公開された公報を基に作成したものである。なおこの公表に係る日本語特許出願(日本語実用新案登録出願)の国際公開の効果は、特許法第184条の10第1項(実用新案法第48条の13第2項)により生ずるものであり、本掲載とは関係ありません。

专利名称(译)	有机EL显示面板及其制造方法		
公开(公告)号	JPWO2008149499A1	公开(公告)日	2010-08-19
申请号	JP2008553969	申请日	2008-05-21
[标]申请(专利权)人(译)	松下电器产业株式会社		
申请(专利权)人(译)	松下电器产业株式会社		
[标]发明人	吉田英博 北村嘉朗 山室景成		
发明人	吉田 英博 北村 嘉朗 山室 景成		
IPC分类号	H05B33/12 H01L51/50 H05B33/22		
CPC分类号	H01L27/3246 H01L27/3211 H01L27/3283 H01L51/5048 H05B33/22		
FI分类号	H05B33/12.B H05B33/14.A H05B33/22.Z H05B33/22.C		
F-TERM分类号	3K107/AA01 3K107/BB01 3K107/CC33 3K107/CC45 3K107/DD60 3K107/DD70 3K107/DD72 3K107/DD89 3K107/DD91 3K107/DD95 3K107/DD96 3K107/EE03 3K107/EE07 3K107/GG06 3K107/GG07 3K107/GG08 3K107/GG24		
优先权	2007143906 2007-05-30 JP		
其他公开文献	JP4328384B2		
外部链接	Espacenet		

摘要(译)

提供一种有机EL显示板，其具有厚度恒定的聚合物有机EL层。本发明的有机EL显示屏包括：设置在基板上的阳极；设置在其上设置有阳极的基板表面上的空穴传输层；设置在空穴传输层上的空穴传输层，形成区域的线状堤；设置在像素区域中的线状中间层；设置在像素区域中和中间层上方的线状聚合物有机EL层；并且阴极电极设置在聚合物有机EL层上。

